博士論文

固体材料界面での多孔性金属錯体作製技術の開発 ならびに機能性物質の創製

平成 31 年 2 月

甲南大学大学院

フロンティアサイエンス研究科 生命化学専攻

大橋 卓史

目次

第1章 序論

1.1 矿	F究の背景	1
1.1.1	Metal-Organic Framework (MOF)	1
1.1.2	MOF の化学的機能	2
1.1.3	MOF の合成	5
1.1.4	固体材料表面上での MOF 合成	7
1.2 本	、論文の目的と構成	10
1.3 参	考文献	13

第2章 金属ナノ粒子表面上での MOF 合成

2.1 はじめに	16
2.2 実験方法	17
2.2.1 PVP 修飾 Ag ナノ粒子の合成	17
2.2.2 Ag ナノ粒子@MOF コア・シェル構造体の作製	18
2.2.3 Ag ナノ粒子@MOF 複合体の触媒能評価	18
2.3 実験結果および考察	18
2.3.1 PVP 修飾 Ag ナノ粒子の構造および物性評価	18
2.3.2 Agナノ粒子@MOF 複合体の構造および物性評価	20
2.3.3 Ag ナノ粒子表面上での MOF 形成メカニズム	21
2.3.4 Agナノ粒子@MOF 複合体の触媒特性	23
2.4 まとめ	26
2.5 参考文献	27

第3章 金属ナノ粒子@mSiO₂ナノ構造体表面上での MOF 合成

3.1	はじめに	29
3.2	実験方法	30
3.2.	.1 <i>m</i> SiO ₂ 機能化 Au ナノ粒子の合成	30
3.2.	2 Au ナノ粒子@mSiO ₂ @MOF 3 層構造体の作製	31

3.2.3 色素内包 Au ナノ粒子@ <i>m</i> SiO ₂ @MOF 3 層構造体の作製	31
3.3 実験結果および考察	31
3.3.1 <i>m</i> SiO ₂ 機能化 Au ナノ粒子の構造および物性評価	31
3.3.2 Au ナノ粒子@ <i>m</i> SiO ₂ @MOF 3 層構造体の構造および物性評価	32
3.3.3 Au ナノ粒子@ <i>m</i> SiO ₂ 表面上での MOF 形成メカニズム	35
3.3.4 色素内包 Au ナノ粒子@ <i>m</i> SiO ₂ @MOF 3 層構造体の物性評価	37
3.4 まとめ	40
3.5 参考文献	41

第4章 高分子フィルム上での MOF 合成

4.1	.1 はじめに 43		
4.2	実験方法	44	
4.2.	1 金属イオンドープポリイミドフィルムの調製	44	
4.2.	2 ポリイミドフィルム表面上での MOF 合成	45	
4.2.	3 ポリイミドフィルム表面上での異種 MOF 合成	45	
4.3	実験結果および考察	46	
4.3.	1 ポリイミドフィルムの表面改質と金属イオンの吸着	46	
4.3.	4.3.2 ポリイミドフィルム表面上での MOF 合成 4		
4.3.3 MOFの膜厚・成長速度に及ぼす吸着金属イオン量の影響 4			
4.3.	4.3.4 MOFの膜厚・成長速度に及ぼす有機配位子濃度の影響 50		
4.3.	5 本手法の汎用性評価	51	
4.4	まとめ	52	
4.5	参考文献	53	

第5章 高分子フィルム上での MOF の配向制御

5.1 V	よじめに	55
5.2 実	ミ験方法	55
5.2.1	銅イオンドープポリイミドフィルムの調製	57
5.2.2	ポリイミドフィルム表面上でのピラードレイヤー型 MOF の配向	57
	制御	

5.3 美	こ 験結果および考察	57
5.3.1	メタノール溶液中で合成した[Cu2(ndc)2(dabco)] _n の結晶配向	57
5.3.2	ブタノール溶液中で合成した[Cu2(ndc)2(dabco)]nの結晶配向	59
5.3.3	溶媒の極性が[Cu ₂ (ndc) ₂ (dabco)] _n の結晶配向に及ぼす影響	61
5.3.4	[Cu2(ndc)2(dabco)]nの反応経時変化の観察	63
5.3.5	[Cu ₂ (ndc) ₂ (dabco)] _n の結晶配向制御のメカニズム	65
5.4 불	ことめ	67
5.5 参	*考文献	67

第6章 高分子フィルム上での MOF の結晶成長プロセスの制御

6.1 はじめに	69
6.2 実験方法	70
6.2.1 亜鉛イオンドープポリイミドフィルムの調製	70
6.2.2 ポリイミドフィルム表面上での ZIF-8 合成	70
6.3 実験結果および考察	71
6.3.1 ポリイミドフィルム表面上での ZIF-8 合成	71
6.3.2 NaNO ₃ 濃度が ZIF-8 の結晶成長速度に及ぼす影響	72
6.3.3 リガンド濃度が ZIF-8 の結晶成長速度に及ぼす影響	74
6.3.4 金属イオンの溶出速度と ZIF-8 の結晶成長速度の系統	売的制御 76
6.3.5 ZIF-8 の結晶成長メカニズム	79
6.4 まとめ	80
第7章 本研究のまとめ	81
謝辞	84
論文リスト	
公表論文(副論文)リスト	85
総説リスト	87

学会発表リスト 88

付録

公表論文(副論文)	別刷り	9 編	ゴ田
総説別刷り		1 編	ゴ用

第1章 序論

1.1 研究の背景

1.1.1 Metal-Organic Framework (MOF)

多孔性物質とは固体の構造内部に多数の微細な孔を有する材料群であり、単位重量 あたり膨大な表面積と孔容積をもつことから触媒の担体や汚染物質の除去剤として、 あるいは近年では、光学・医療用材料として応用されるなど多岐に亘る分野で注目を 集めている[1-4]。この多孔性材料の代表的な物質として、ゼオライトや活性炭、シリカ ゲルが挙げられる。活性炭・シリカゲルは主に吸着材として産業において大きな地位 を占めており^[5,6]、ゼオライトは吸着材としてのみならず、触媒として多数の工業的プ ロセスに用いられており、最も重要な多孔体のひとつである^[7,8]。他にも、モンモリロ ナイトやハイドロタルサイトなどの層状化合物やメソポーラスシリカなど、様々な多 孔体が報告されているが、この分野において、1990 年代後半に新たに見出された材料 として多孔性金属有機構造体(Metal-Organic Framework: MOF)がある^[9-11]。MOF は 金属イオンと有機配位子の自己集合により得られる多孔性物質であり、結節点となる 金属イオンを有機配位子が架橋することによりフレームワーク構造が構築され、フレ ームワーク内の空隙が分子を取り込む空間として働く。MOF は通常、溶液中の反応 によって合成されるため、合成直後は細孔内部に溶媒分子を包接した状態であるが、 このゲスト分子を除去することにより多孔性材料としての利用が可能となる。1997年 に北川進らによって、ゲスト分子を除いても安定に構造を維持し、さらにガス分子の 吸着が可能であることが報告され^[12]、以降、新たな多孔性材料として MOF の研究が 盛んに行われている。

MOF が他の多孔性物質とは大きく異なる点として、「フレームワークの設計性」、 「大きな比表面積」、「柔軟性」が挙げられる(図1.1)。多様な配位数・配位構造を有 する金属イオンと構造設計可能な有機配位子とを合理的に組みわせることにより、ゼ オライトや活性炭など従来の多孔体では困難であった多様かつ均一な細孔構造の構 築を容易に実現することが可能である。また、フレームワーク内に含まれる原子の大 半が細孔界面に露出しているため、比表面積が非常に高いといった特徴を有している。 さらに、フレームワークが配位結合や水素結合、分子間力といった共有結合よりも弱 い結合を利用して組み上がっているため、温度やガスの圧力に応じて立体構造が変化

1



Figure 1.1. Various unique functions of MOF crystals.

するなど、結晶性物質でありながら柔軟性を示すというユニークな特徴も有している。 このように、MOF は構造均一性・多様性・高比表面積・柔軟性といった特徴を兼ね備 えた新奇な多孔性材料であり、現在幅広い分野での用途展開が期待されている。本節 では、上記のようなユニークな特徴を有している MOF の機能について言及した後、 研究の発展と共に多様化してきた MOF の合成法について紹介する。

1.1.2 MOF の化学的機能

MOFの細孔サイズは数 Å~数十 Å 程度であり、分子レベルの世界である。このよう な分子レベルの細孔に取り込まれたゲスト分子は、独特の振舞いをすることが知られ ている。例えば、細孔壁からの相互作用を受けて多孔体内にゲストが安定に存在しう る場合、その多孔体は貯蔵材料として利用できる。また、ゲストの取り込みや放出に 選択性がある場合は分離材料となり、ゲストを化学的に変化させうる場合には触媒と なる。これらの機能をもつ多孔性材料として、ゼオライトや活性炭は既に石油化学や ガス分離などの分野で広く実用化されている。一方、MOF は開発の歴史が浅く工業 規模での実用例はまだないが、MOF ならではの特色ある機能の報告が相次いでいる。 そこで本項では、MOF の「貯蔵」、「分離」、「触媒」機能を概観する。

MOF を利用した物質貯蔵では、ガスの貯蔵が最も盛んに検討されている。低分子 の有機分子からなる細孔壁で構成されている MOF は、空隙率が極めて高いという特 徴を有しているため多量のガスを低圧で貯蔵することが可能となる。そのため、近年 では多くの自動車メーカーにて、MOF をメタンガス貯蔵材として積載した自動車や 水素貯蔵材として利用した燃料電池自動車の開発が盛んに行われている[13]。他にも、 MOF のユニークなガス貯蔵例として、アセチレンの分子整列貯蔵が挙げられる^[14]。 $[Cu_2(pzdc)_2(pyz)]_n$ (pzdc = ピラジン-2,3-ジカルボン酸、pyz = ピラジン) と呼ばれる MOF の細孔内にはカルボキシ基が整然と配列しており、そのサイトとアセチレンが 相互作用することによりアセチレンが細孔内で一列に整列する。アセチレン分子は反 応性が高く圧縮により爆発する恐れがあるが、MOF を利用して整列貯蔵すれば分子 同士の衝突を抑制でき、単純なボンベでの圧縮充填よりも 200 倍もの高密度でアセチ レンを貯蔵することができる。また、同様の原理にて MOF 細孔内に酸素分子を整列 貯蔵させた場合には、酸素はバルクとは異なった磁気的・光学的性質を示すため[15]、 従来の固体材料とは異なる新たなナノ材料の創出が期待できる。これらは、細孔壁の 機能化が可能で規則性の高い細孔を結晶内部に有している MOF ならではの貯蔵であ り、高性能な貯蔵材料としての期待が高まっている。

さらに MOF は、大きさや拡散速度の異なる分子を分離する効果(分子ふるい効果) をもつ。このふるい効果そのものは、ゼオライトや活性炭などの多孔体にも共通する 機能であるが、MOF の構造柔軟性は分子ふるい効果に特殊な機能を付与することが 可能である。一般的にゼオライトや活性炭では、ガス圧力の上昇に伴い吸着量が単調 に増加する I型(IUPAC分類)の吸着等温線を示すことが知られている。多くの MOF も I型の吸着プロファイルを示すが、柔軟な骨格を有した MOF では図 1.2 で表され るような特徴的な吸着プロファイルを示すことがある。このユニークな吸着等温線は、 MOF が一定圧を超えた時点から急激にガスを吸着し始める性質を有していることを 表している。このような吸着現象は、ON/OFF 的なガス吸着挙動からゲート吸着と呼 ばれ、X線構造解析より図 1.2 に示すような構造変化に基づいて生じていることが明 らかとされている。ガスの圧力が低いときには、(a) のような格子状の基本骨格が緻 密に積層しているためガスを吸着しないが、圧力が一定圧を超えると、格子同士が層 間相互作用で緻密に積層しているよりも、ガス分子を層間に取り込んだ方が安定化す るため(b)の状態へと構造が変化する。そのため、ガスの急激な吸着が生じる^[16]。

3



Figure 1.2. Adsorption characteristic and structural change of flexibility MOF.

これは、結晶性物質でありながら構造柔軟性を示すという MOF のユニークな性質に 基づいたものであり、従来の「硬い」多孔体では発現することのない興味深い機能で ある。

MOFの大きな表面積の活用として、その表面における触媒反応も志向されている。 MOFの触媒作用は配位子または配位不飽和な金属サイトが活性点となるが、それら の要素を自由に組み込むことが可能であるため、これまでに Knoevenagel 縮合、Heck 反応、酸化反応など多彩な反応を触媒する MOF が報告されている^[17-19]。構造設計性 の高い MOF は、有効な反応空間を残したまま配位子の官能基を系統的に変更したり、 不斉部位を高度に配列させたりすることが可能であることに加え、ヘテロポリ酸、低 分子錯体、金属クラスター・ナノ粒子などの触媒能をもつ機能性物質を細孔内に導入 することもできることから^[20-24]、オーダーメイド可能な付加価値の高い触媒として位 置づけられている。金属-有機物の複合体である MOF は、無機物であるゼオライトと 比較して安定性の面で劣りはするものの、設計の自由度の高さから触媒としても限り ない可能性を秘めている。

1.1.3 MOF の合成

MOF は金属イオンと有機配位子の自己集合過程を経て結晶固体として得られる。 分子性結晶とは異なり、MOF は結晶化の際に配位結合形成という化学反応を伴うた め、用いる金属イオンと有機配位子の結合性の違いにより様々な合成方法が用いられ ている。これまで、望みの構造を作り上げるため、そして目的の物性を発現させるた め、様々な工夫を凝らした合成法が開発されてきた。なかでも、主に用いられている アプローチは、液層拡散法、ソルボサーマル法、マイクロ波照射法、固相合成法であ る。以下、簡単に各手法について概説する。

MOF の合成で最もシンプルなものは、常温・常圧で金属イオンと有機配位子の溶 液を混合する方法である。ただし、金属イオンと有機配位子の反応性が非常に高い場 合、それぞれの溶液を混合すると直ちに沈殿が生じ、多くの場合はアモルファスが生 成される。結晶性の高いフレームワークを構築させるためには、配位結合の可逆性に より熱力学的に安定な構造にする必要があるが、高い反応性のため配位様式が一様で なく結晶化しない。その際に用いられるのが、液層拡散法である。液層拡散法は、ガ ラスの直管に金属イオンと有機配位子の2つの溶液を層をなすように順番に注入す ることで、液-液界面でゆっくりと溶質を拡散・混合させる手法である。置換活性な金 属イオンを用いる系では、この液-液界面で金属イオンと有機配位子とが連結して結 晶核が生成される。さらに、上下の溶液からの拡散による物質供給速度が適切であれ ば、生成された結晶核の表面に金属イオンと有機配位子が交互に配位し続けるという 結晶成長プロセスを経て、結晶性の高い単結晶が得られる。この手法により、MOF に ガス吸着能があることが初めて報告された[Co2(bpy)3(NO3)4](bpy = 4,4'-bipyridyl)を 始め、ピラードレイヤー型 MOF や相互嵌合構造をもつ CID シリーズなど、多くの単 結晶が合成されている^[25-27]。また拡散法において、液-液界面に固体が生じているが、 十分な大きさの単結晶にまで成長しない場合がある。これは、混合速度が速すぎて二 溶液接触の初期段階での核生成量が多くなり、ひとつひとつの結晶に前駆体が十分に 供給されていないことが原因である。この際には溶質の濃度を下げるか、または二溶 液間に溶媒中間層を挟んで過剰な核生成を抑制し、結晶成長に適した混合速度に調整 することにより十分な大きさの単結晶を得ることが可能となる。

置換不活性な金属イオンまたは常温・常圧ではどの溶媒に対しても溶解性が低い有 機配位子を用いる場合や、室温下では十分な反応の活性化エネルギーが得られない場

 $\mathbf{5}$

合にソルボサーマル法がよく用いられる。ソルボサーマル法は、耐圧式の密封容器内 に MOF 前駆体と溶媒を入れ、溶媒の沸点以上に加熱することで高温・高圧下で合成 を行う手法である。ソルボサーマル法のうち、溶媒に水を用いる系は水熱合成法とし て知られている。この手法は、(1)高温・高圧下では反応物の溶解性や反応性が向上 する、(2)濃度・pH・加熱温度・反応時間などの合成条件をプログラム可能、(3)急 激な加熱と穏やかな冷却という非平衡な結晶化過程を経る、といった特徴を有する。 そのため、ソルボサーマル法では熱力学的に最安定な構造だけでなく、速度論的に安 定な準安定構造を得ることもできることから、新規 MOF 構造体合成の強力な手法と して幅広く用いられている。

マイクロ波照射法では反応容器に MOF 前駆体と溶媒を入れ、マイクロ波を照射す ることで MOF 合成を行う。マイクロ波の照射環境下では、分子はマイクロ波による 電場の変化に伴い回転する。このとき、電場の変化に対し分子回転に遅れが生じてエ ネルギーの散逸が起こり、その散逸したエネルギーが熱に変わることにより反応系内 が加熱される。そのため熱伝導や対流などの影響を受けず、従来の熱伝導式加熱法と 比べて系全体を均一かつ短時間で加熱できることが最大の特徴である。これにより、 反応速度を大幅に加速させることができ、短時間での MOF 合成が可能となる^[28]。ま た、温度調整により結晶成長速度の制御が容易に行えるため、マイクロ波照射法は結 晶サイズの制御やナノ粒子の合成に対して非常に有用な手法である。

固相合成法は、MOF 前駆体を溶媒を用いずに機械的に混合することで合成する手法である。この手法の利点は、溶媒を使用しないため溶解性の低い金属塩や有機配位子を用いることができる点である。例えば、酸化亜鉛などの酸化物は一般的に溶媒に溶けにくいため MOF 合成には不向きであるが、固相合成法を用いることにより金属酸化物を金属塩として用いることが可能となる^[29]。またこの手法は、直接試薬を混ぜるため短時間での合成が可能であり、かつ溶媒を使用しない分だけコストを抑えることもでき、コストパフォーマンスが良いことも特徴である。

以上、代表的な MOF 合成手法を紹介した。また上記の手法以外にも、MOF 合成に は金属錯体合成に馴染みの薄かった他分野の手法が積極的に取り込まれており、優れ た成果が数多く挙げられている。それら多種多様な合成法を使いこなすことにより、 これまでに数百種類以上もの MOF が合成されてきた。また、近年では単一化合物の 合成だけでなく、合成後修飾法と呼ばれる手法を活用することによりオンデマンドで MOF 結晶の表面や内部に異なる分子を集積させることが可能となっている^[30-32]。こ の合成後修飾法は、一旦合成した MOF の骨格構造を固体のまま化学的に修飾する手 法であり、これにより MOF は複数の機能・物性が連動する新しいシステムへと発展 していくことが期待できる。

1.1.4 固体材料表面上での MOF 合成

多くのユニークな特徴をもつ MOF は、貯蔵材・分離材・触媒材料として優れた機 能を示すことが明らかとされている。また MOF は、金属イオンと有機配位子の組み 合わせならびに合成手法を適切に選択することで様々な細孔構造を構築することが 可能であるため、吸着・分離・触媒活性という機能を合理的に設計することができる。 従来は、有機配位子に置換基を導入することで細孔表面を機能化した MOF マイクロ 結晶を貯蔵材・分離材・触媒材料として応用する研究が主流であった。しかし近年で は、他種材料、特に金属ナノ粒子ならびに二次元基板の表面上に MOF を固定化する ことで、MOF の細孔内機能を変化させることなく多機能性複合材料を構築する研究 が展開されてきている。例えば、金属ナノ粒子表面上で MOF の結晶成長制御を行う

(a) Preparation of MOF Crystals on Metal NPs



(b) Preparation of MOF Crystals on 2-D Substrates



Figure 1.3. Construction of MOF-based functional nanomaterials by formation of MOF crystals on the (a) metal NPs and (b) 2-dimensional substrate.

ことにより、コア・シェル型の金属ナノ粒子@MOF 複合体が構築される。この複合体 では、金属ナノ粒子特有の物理化学的機能に MOF の多孔性機能が兼備されており、 分子選択性を有した触媒・センシングシステムの開発や高性能水素吸蔵材料としての 応用展開が活発に行われている^[33-35](図 1.3a)。また、二次元基板に MOF を固定化す ることにより MOF を薄膜化することができ、高機能分離膜やセンサーデバイスとし ての応用が期待できる(図 1.3b)^[36-38]。このように、固体材料表面上での MOF 合成 は、高性能かつ利便性の高い新たな機能性材料の創製を可能とすることから、10 年ほ ど前から活発に研究が行われている。こういった複合体を作製する際、溶液からの結 晶化による合成法を上手く利用することにより局所的に核形成を起こし、位置選択的 に合成するという視点が非常に重要であり、これまでに様々な手法にて固体材料界面 での MOF 合成が試みられている。ここで、現在盛んに用いられている金属ナノ粒子 @MOF 複合体ならびに MOF 膜作製手法について簡単に概説する(表 1.1, 1.2)。

金属ナノ粒子@MOF 複合体を合成する際によく用いられている手法は、Layer-by-Layer (LbL) 成長法である。LbL 成長法は、あらかじめ合成した金属ナノ粒子を MOF 前駆体溶液 (金属イオン溶液と有機配位子溶液) に交互に分散させることで、ナノ粒

Method	Layer-by-Layer Assembly	Coordination Replication Method
Reaction	Step-by-step	One-pot
Process	Complex	Simple
Controllability	High	Low
Versatility	High	Low

Table 1.1. Typical Approaches for Fabrication of Metal NP@MOF Composites.

Table 1.2. Typical Approaches for Fabrication of MOF Crystal-based Films.

Method	Layer-by-Layer Assembly	Counter Diffusion-based <i>in situ</i> Method
Reaction	Step-by-step	One-pot
Process	Complex	Simple
Controllability	High	Low
Versatility	High	High

子表面上で選択的に MOF を成長させるアプローチであり、反応回数によって容易に MOF の厚みを制御することが可能である^[39,40]。

薄膜作製技術には、材料を溶かした溶液を用いる湿式法としてキャスト法やスピン コート法、乾式法として真空蒸着法が一般的によく知られているが、難溶性材料であ る MOF にはこれらの手法を適用することは難しい。そこで、二次元基板への MOF の 固定化は、基板表面上で直接核形成・結晶成長を促すことにより薄膜化する試みが検 討されている。基板上に直接 MOF を集積させる手法としては、自己組織化単分子膜

(Self-Assembled Monolayer: SAM) で修飾した基板表面上での LbL 成長法が最もよく 用いられている(図 1.4)。LbL 成長法では、反応回数を調整することにより膜厚を精 密に制御することができるだけでなく^[41]、MOF 膜の上に異なるフレームワークを積 層させることも可能であり、多重機能を持ったハイブリッド MOF 膜を構築すること ができる^[42]。また、SAM によって導入された配位サイトの効果により結晶成長の方 向を制御することも可能となる^[43]。結晶の配向が揃うことで細孔方向を揃えることが 可能となるため、より効率的な吸着・分離機能が期待できる。

以上、主に LbL 成長法により、系統的に制御された金属ナノ粒子@MOF コア・シ ェル構造体や膜厚・配向等を制御した MOF 膜を作製することが可能となっている。 しかしながら、LbL 成長法ではそれぞれ金属ナノ粒子および基板表面上で MOF を作 製するために、「金属イオン溶液に浸漬」→「洗浄」→「有機配位子溶液に浸漬」→

「洗浄」という操作を数 10 回繰り返す必要があり、合成プロセスが煩雑で短時間で の合成ができないといった大きな問題点を抱えている。

LbL 成長法以外にも、金属ナノ粒子表面上を金属酸化物で被覆し、この金属酸化物







を金属イオン源として利用することによりナノ粒子表面上で MOF を構築する手法が 報告されている^[44]。また、ポーラスアルミナや多孔性セラミックのような多孔性基板 内に金属イオンを吸着させ、その後反応を行うことにより MOF 膜を作製するという 方法も報告されている^[45]。これらの手法では one-pot 合成で MOF を構築することが 可能であるが、金属イオンの溶出(金属酸化物からの溶出および多孔性基板内にドー プした金属イオンの溶出)速度を制御することができないため、MOF の核形成・結晶 成長は固体表面上で不均一に生じてしまい、均一性の高い MOF 結晶膜を得ることが 困難である。このような観点から、固体材料表面上で均一性・連続性に優れた MOF 結晶膜を簡便なプロセスで作製することのできる新たな手法の開発が望まれている。

1.2 本論文の目的と構成

MOF が新たな多孔性材料として注目されて 20 年が経ち、多彩なバックグラウンド をもつ研究者の参入と最先端の技術を駆使することにより、短期間で大きな発展を遂 げてきた。現在、90 年代から盛んに行われてきた新規構造の MOF 探索は下火になり つつあり、新たな合成技術の開発ならびに機能のオンデマンド設計へと移行しつつあ る。それに伴い、国内外の多くの企業も MOF の研究に着手しており、実用化に向け た研究が活発に行われている。なかでも、金属ナノ粒子や二次元基板などの固体材料 界面での MOF 合成は、高性能・多機能性ナノ構造体の創製に繋がり、各種材料の利 点を活かすことで環境・エネルギー・医療といった今日的な課題に対して大きく貢献 できる可能性を秘めているため盛んに研究が行われている。しかしながら、固体材料 界面での MOF 合成に関する研究はまだ歴史が浅く、課題が数多く残っている。その 克服しなければならない点は以下のように要約される。

- (1) 多段階反応を必要としない、簡便な MOF 結晶膜合成プロセスの開発
- (2) 固体界面での MOF の結晶成長メカニズムの解明と自己組織化プロセスの制御

(3) MOF 結晶膜の構造パラメーター(連続性・膜厚・サイズ・配向)の精密制御

これらの課題は一見独立しているように思えるが、それぞれの項目は密接に関連しており、MOF をベースとした機能性ナノ構造体を合目的に作製するためには一連の流れで取り組む必要があると考えられる。また、金属ナノ粒子@MOF 複合体と MOF 膜の合成はともに LbL 成長法に基づいたものが主流であるものの、これらの国内外



(i) Control of Growth Process of MOF Crystals on Metal NPs

Figure 1.5. Schematic illustrations of this study

の研究は独立に行われており、固体材料表面での MOF 形成に対する一般的な合成指 針は提唱されていない。そこで本研究では、コロイド微粒子ならびに二次元基板とい った異なる固体材料表面上での自己組織化制御可能な MOF 作製技術の開発を目的と した。各材料表面上で MOF の結晶成長の制御ならびにその成長メカニズムの解析を 行い、得られたデータを発展的に結合し合うことで固体界面での MOF の自己組織化 プロセスに関する知見を得ることができ、MOF をユニットとした機能性ナノ構造体 を作製する際の設計指針を提案することが可能になるとの着想に至った。したがって 本論文では、上記 3 つの課題を克服するための手法を提案し、それを実践した結果に ついて述べる。本論文は、機能性物質の創製を志向した固体材料表面上での新規 MOF 作製技術の開発を目的とし、(i) 金属ナノ粒子表面上での MOF の自己組織化制御 らびに合成試料の機能評価、(ii) 高分子フィルム表面上での MOF の自己組織化制御 の 2 点を指向した研究から構成されている(図 1.5)。

第2章では、金属ナノ粒子表面上で選択的に MOF を成長させることのできる手法 について述べる。金属ナノ粒子表面を高分子で修飾することで、あらかじめ MOF 前 駆体である金属イオンを大量かつ化学的にトラップすることが可能となり、続いて有 機配位子と反応させることにより MOF の核形成および結晶成長が粒子表面上に限定 され、金属ナノ粒子@MOF コア・シェル構造体を作製することに成功した。一方、金 属イオンの局在化処理を行わずに合成を行った際は、コア・シェル構造体ではなくナ ノ粒子と MOF が凝集した複合体が得られることを確認した。第2章に示した研究成 果から、MOF の自己組織化サイトを特定位置に限定するためには、あらかじめその 位置に金属イオンを局在化させておくことが重要な鍵であることが明らかとなった。

第3章では、コロイド粒子として金属ナノ粒子@メソポーラスシリカ(mSiO₂)ナ ノ構造体界面での MOF 合成について述べる。mSiO₂表面のシラノール基と金属イオ ン間の高い親和性を利用することにより、mSiO₂表面上でも MOF を作製することが 可能であることを確認した。さらに MOF の詳細な成長メカニズムの解明にも成功し、 MOF を機能性ユニットとした材料を設計する際の重要な知見を得ることができた。 また合成した複合体には、金属ナノ粒子・mSiO₂・MOF の3種類の材料の機能が統合 されていることも確認しており、多方面への応用可能性が示された。

第4章では、高分子フィルム表面上での MOF 形成プロセスについて述べる。第2 章で得た知見をもとに、金属イオンをドープした高分子フィルムを調製し、それを MOF 膜形成の支持基板ならびに金属イオン供給源として利用することで、基板表面 上で選択的に MOF を成長させることに成功した。また、ドープする金属イオン量を 調整することで、MOF 膜の厚みを合目的に制御することが可能であることを確認し ている。さらに本手法は、ドープする金属イオン種ならびに有機配位子の種類を変え ることで、様々なフレームワークにも適用可能であることから汎用性の高い手法であ るといえる。第2章に加えて第4章にて得られた研究成果から、金属イオンをドープ した支持材料を用いることで、one-pot 合成でも固体材料表面上で選択的に MOF を成 長させることが可能であることが明らかとなった。

第5章では、MOF 膜の結晶配向制御可能な合成プロセスについて述べる。金属イ オンをドープした高分子フィルム表面上でピラードレイヤー型 MOF の結晶配向制御 を試みたところ、高分子フィルムと MOF 構成要素である二次元レイヤー間の化学的 相互作用を制御することにより、得られる MOF 結晶膜の配向を揃えることに成功し た。本手法では、one-pot 反応でも二次元レイヤーの形成とピラー配位子の架橋を2段 階に分けて制御することが可能であり、実験条件を最適化することで MOF 膜の結晶 配向が揃うことを確認した。

第6章では、金属イオンをドープした高分子フィルム表面上での MOF の結晶成長 の合目的制御可能な合成プロセスについて述べる。本手法では、高分子フィルム内に ドープした金属イオンの溶出速度と MOF の結晶成長速度を独立して制御することの

12

できるプロセスを確立することにより、サイズの均一性が高くかつ系統的に制御した MOF 連続膜を作製することに成功した。第4,5章ならびに第6章にて得られた成果 から、金属イオンドープ高分子フィルムを用いることで、one-pot 反応で膜厚・結晶配 向・サイズを合目的に制御した MOF 膜を作製することが可能であることが明らかと なり、上述した課題をクリアした新規 MOF 膜作製技術としての応用可能性が示され た。

最後に、第7章で本研究を総括する。

1.3 参考文献

- 1. J. Kim, M. Choi, R. Ryoo, J. Catal. 2010, 269, 219
- 2. S. Yoshida, N. Ogawa, K. Kamioka, S. Hirano, T. Mori, Adsorption 1999, 5, 57
- S. Inagaki, O. Ohtani, Y. Goto, K. Okamoto, M. Ikai, K. Yamanaka, T. Tani, T. Okada, Angew. Chem., Int. Ed. 2009, 48, 4042
- 4. J. Lu, M. Liong, J. I. Zink, F. Tamanoi, Small 2007, 3, 1341
- 5. A. C. Dillon, K. M. Jones, T. A. Bekkedahl, C. H. Kiang, D. S. Bethune, M. J Heben, *Nature* **1997**, 386, 377
- 6. T. Asefa, M. J. MacLachlan, N. Coombs, G. A. Ozin, Nature 1999, 402, 867
- 7. E. Erdem, N. Karapinar, R. Donat, J. Colloid Interface Sci. 2004, 280, 309
- 8. C. D. Chang, A. J. Silvestri, J. Catal. 1997, 47, 249
- 9. S. Kitagawa, R. Kitamura, S. Noro, Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 2334
- O. M. Yaghi, M. O'Keeffe, N. W. Ockwing, H. K. Chae, M. Eddaoudi, J. Kim, *Nature* 2003, 423, 705
- 11. G. Férey, Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 191
- M. kondo, T. Yoshitomi, K. Seki, H. Matsuzaka, S. Kitagawa, Angew. Chem. Int. Ed. 1997, 36, 1725
- 13. M. Jacoby, Chem. Eng. News 2008, 86, 13
- R. Matsuda, R. Kitamura, S. Kitagawa, Y. Kubota, R. V. Belosudov, T. C. Kobayashi, H. Sakamoto, T. Chiba, M. Takata, Y. Kawazoe, Y. Mita, *Nature* 2005, 436, 238

- R. Kitaura, S. Kitagawa, Y. Kubota, T. C. Kobayashi, K. Kindo, Y. Mita, A. Matsuo, M. Kobayashi, H.-C. Chang, T. C. Ozawa, M. Suzuki, M. Sakata, M. Takata, *Science* 2002, 298, 2358
- A. Kondo, H. Noguchi, S. Ohnishi, H. Kajiro, A. Tohdoh, Y. Hattori, W.-C. Xu. H. Tanaka, H. Kanoh, K. Kaneko, *Nano Lett.* 2006, 6, 2581
- V. N. Panchenko, M. M. Matrosova, J. Jeon, J. W. Jun, M. N. Timofeeva, S. H. Jhung, J. Catal. 2014, 316, 251
- 18. M. A. Gotthardt, A Beilmann, R. Schoch, J. Engelke, W. Kleist, RSC Adv. 2013, 3, 10676
- 19. A. Dhakshinamoorthy, M. Alvaro, H. Garcia, ACS. Catal. 2011, 1, 836
- Y. C. Sun, X. S. Liu, D. D. Liang, Z. K. Shao, H. Y. Ren, M. Z. Su, J. Am. Chem. Soc.
 2009, 131, 1883
- 21. L. Chen, S. Rangan, J. Li, H. Jiang, Y. Li, Green Chem. 2014, 16, 3978
- 22. K. M. Choi, K. Na, G. A. Somorjai, O. M. Yaghi, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 7810
- W. Zhang, G. Lu, C. Cui, Y. Liu, S. Li, W. Yan, C. Xing, Y. R. Chi, Y. Yang, F. Huo, *Adv. Matter.* 2014, 26, 4056
- 24. L. Chen, Y. Peng, H. Wang, Z.i Gu, C. Duan, Chem. Commun. 2014, 50, 8651
- 25. M. kondo, T. Yoshitomi, H. Matsuzaka, S. Kitagawa, Angew. Chem. Int. Ed. 1997, 36, 357
- M. kondo, T. Okubo, A. Asami, S. Noro, T. Yoshitomi, S. Kitagawa, T. Ishii, H. Matsuzaka,
 K. Seki, Angew. Chem. Int. Ed. 1999, 38, 140
- 27. S. Horike, D. Tanaka, K. Nakagawa, S. Kitagawa, Chem. Commun. 2007, 3395
- 28. J. Klinowski, F. A. A. Paz, P. Silva, J. Rocha, Dalton Trans. 2011, 40, 321
- J. P. Beldon, L. Fabian, S. R. Stein, A. Thirumurugan, K. A. Cheetham, T. Friščić, Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 9640
- 30. C. Volkringer, S. M. Cohen, Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 4644
- T. Gadzikwa, O. K. Farha, C. D. Malliakas, M. G. Kanatzidis, J. T. Hupp, S. T. Nguyen, J. *Am. Chem. Soc.* 2009, 131, 13613
- 32. L. Ma, C. D. Wu, M. M. Wanderley, W. Lin, Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 8244
- D. Esken, S. Turner, O. I. Lebedev, G. V. Tendeloo, R. A. Fischer, *Chem. Mater.* 2010, 22, 6393
- 34. K. Sugikawa, S. Nagata, Y. Furukawa, K. Kokado, K. Sada, Chem. Mater. 2013, 25, 2565

- G. Li, H. Kobayashi, J. M. Taylor, R. Ikeda, Y. Kubota, K. Kato, M. Takata, T. Yamamoto,
 S. Toh, S. Matsumura, H. Kitagawa, *Nature Materials* 2014, 13, 802
- 36. Z. Kang, M. Xue, L. Fan, J. Ding, L. Guo, L. Gao, S. Qiu, Chem. Commun. 2013, 49, 10569
- L. Ye, J. Liu, Y. Gao, C. Gong, M. Addicoat, T. Heine, C. Wöll, L. Sun, J. Mater. Chem. A 2016, 4, 15326
- S.-M. Chen, M. Liu, Z.-G. Gu, W.-Q. Fu, J. Zhang, ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 27332
- 39. F. Ke, L.-G. Qiu, Y.-P. Yuan, X. Jiang, J.-F. Zhu, J. Mater. Chem. 2012, 22, 9497
- 40. A.-L. Li, F. Ke, L.-G. Qiu, X. Jiang, Y.-M. Wang, X.-Y. Tian, *CrystEngComm* **2013**, 15, 3554
- 41. J. Nan, X. Dong, W. Wang, W. Jin, N. Xu, Langmuir 2011, 27, 4309
- M. Meilikhov, S. Furukawa, K. Hirai, R. A. Fischer, S. Kitagawa, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 341
- 43. B. Liu, M. Tu, R. A. Fischer, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 3402
- K. Khaletskaya, J. Reboul, M. Meilikhov, M. Nakahama, S. Diring, M. Tsujimoto, S. Isoda,
 F. Kim, K. Kamei, R. A. Fischer, S. Kitagawa, S. Furukawa, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 10998
- 45. H. T. Kwon, H.-K. Jeong, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 10763

第2章 金属ナノ粒子表面上での MOF 合成

2.1 はじめに

MOF はこれまでに多様な機能を示すことが報告されており、現在、その基本的な 科学(合成、構造、性質)から応用への展開が精力的に行われている^[1,2]。従来は様々 な応用に対して、有機配位子に置換基を導入することで細孔表面を機能化した MOF 結晶がよく用いられてきたが^[3-5]、近年では他種材料と複合化することにより多機能 を有した材料を合成する試みが盛んに行われている[6-8]。そのなかでも、特に活発に行 われている研究のひとつに「金属ナノ粒子表面上での MOF 合成」が挙げられる。金 属ナノ粒子は、量子サイズ効果によりバルクとは異なる特異な物理的・化学的性質を 示すことが知られており、触媒科学、エネルギー・環境技術、医療等のナノテクノロ ジーに関わる分野で幅広く研究・実用化がなされている^[9-12]。この金属ナノ粒子と MOF から構築された複合体は、ナノ粒子の性質と MOF の多孔性機能を兼備した材料 であり、分子選択性を有した新たな触媒、センシング、貯蔵システム等を展開するこ とが可能であることから多岐に亘る分野で注目を集めている^[13-16]。この金属ナノ粒子 @MOF 複合体を合成する際、如何に効果的に MOF の核生成および結晶成長を粒子表 面上で誘発させるかが非常に重要であり、この課題に対して Layer-by-Layer (LbL) 成 長法による複合体合成を中心に盛んに研究が行われている。LbL 成長法は、金属ナノ 粒子を MOF 前駆体溶液(金属イオン溶液および有機配位子溶液)に交互に分散させ て、ナノ粒子表面上で一層ずつ MOF を積層させるというシンプルなアプローチであ り、反応回数によって容易に MOF の厚みを制御することができるという特徴をもつ ^[17,18]。しかしながら、十分な厚みをもつ MOF の合成に多くの反応回数および時間を 要するといった問題点がある。LbL 成長法以外にも、金属ナノ粒子表面上を金属酸化 物で被覆し、その金属酸化物を金属イオン源として利用することによりナノ粒子表面 上で MOF を合成する手法が報告されている^[19]。この手法では短時間での MOF 合成 が可能であるが、金属酸化物からの金属イオンの溶出速度を制御することができず、 ナノ粒子表面上で選択的に MOF を成長させることが困難である。

これらの課題に対して本研究では、金属ナノ粒子と反応溶液の固液界面に着目し、 2つの異なる相から MOF 前駆体を供給することにより、反応成長サイトをナノ粒子/ 反応溶液の固液界面に限定した新規合成手法を提案する。本章では、高分子修飾 Ag



Figure 2.1. Schematic illustration of the proposed approach for the construction of Ag NP@MOF core-shell structures using metal ions-localized NPs.

ナノ粒子表面上での選択的 MOF 形成を試み(図 2.1)、さらにその反応経時変化を観 察することにより、ナノ粒子表面上での MOF の形成メカニズムについて評価した。 また、作製した複合体が実際に金属ナノ粒子と MOF の性質を兼備した材料であるこ とを確認するため、本複合体の触媒能を評価することで機能性複合材料としての有用 性について検討した。

2.2 実験方法

2.2.1 PVP 修飾 Ag ナノ粒子の合成

ポリビニルピロリドン (PVP) 修飾 Ag ナノ粒子は既報の手法を利用して合成した ^[20]。DMF 溶液 40 mL に 10 wt% PVP (分子量 40000) 水溶液 (5.0 mL) を加え、次い で 80 °C で加熱しながら 0.125 M 硝酸銀水溶液 (5.0 mL) をゆっくり滴下し、3 時間 加熱することにより PVP 修飾 Ag ナノ粒子を合成した。合成後は、遠心分離 (15000 rpm, 1 時間) および DMF 洗浄を 3 回行うことにより試料の精製を行った。得られた PVP 修飾 Ag ナノ粒子は、フーリエ変換赤外分光スペクトル測定装置 (日本分光製 FT-IR670、以下 FT-IR)、透過型電子顕微鏡 (日本電子製 JEM1400、以下 TEM)、X 線 回折装置 (リガク社製 UltimaIV、以下 XRD)、ならびに紫外・可視分光光度計 (日本 分光製 V-550、以下 UV-vis) により評価した。

2.2.2 Ag ナノ粒子@MOF コア・シェル構造体の作製

MOF には亜鉛イオンと 2-メチルイミダゾール (MeIM) から構築される ZIF-8 $([Zn(MeIM)_2]_n)$ をターゲットとした。まず、190 μ M Ag ナノ粒子分散 DMF 溶液 1.0 mL に 3.6 mM 硝酸亜鉛 DMF 溶液 (2.0 mL) を加え、室温下で 30 分間撹拌すること により、Ag ナノ粒子表面を修飾している PVP 分子に MOF 前駆体となる亜鉛イオン を捕捉させた。この亜鉛イオン局在化処理の後、17 mM MeIM DMF 溶液 (2.0 mL) を 加え、マイクロウェーブ照射により 200 °C で 1.5 時間加熱することにより ZIF-8 の合 成を行った。得られた試料は、TEM, XRD, UV-vis, ならびに窒素吸着測定 (スペクト リス株式会社製 NOVA4200*e*) により評価した。

2.2.3 Ag ナノ粒子@MOF 複合体の触媒能評価

上記プロセスにて作製した Ag ナノ粒子@ZIF-8 複合体を触媒として用いて、4-ニト ロフェノールの還元反応を行った。まず、窒素雰囲気下で 0.1 M 水素化ホウ素ナトリ ウム/0.1 mM 4-ニトロフェノール混合水溶液 (30 mL) を調製した。次いで、この反応 溶液に Ag ナノ粒子@ZIF-8 複合体分散水溶液 150 µL (Ag 含有量 1.8×10⁻¹² mol) を撹 拌しながら加えた。反応基質(4-ニトロフェノール)および生成物(4-ニトロナフト ール)ともに可視紫外領域に吸収ピークを示すことから、UV-vis 測定にて反応溶液を 2 分毎にモニタリングすることにより反応の進行具合を評価した。また、作製した Ag ナノ粒子@ZIF-8 複合体の分子ふるい効果を評価するため、同様のプロセスにて 4-ニ トロ-1-ナフトールの還元反応も行った。さらに対照実験として、MOF で被覆してい ない PVP 修飾 Ag ナノ粒子単体 (Ag 含有量 1.8×10⁻¹² mol)を触媒として用いて、4-ニ トロフェノールならびに 4-ニトロ-1-ナフトールの還元反応を行い、UV-vis 測定によ りその触媒活性を評価した。

2.3 実験結果および考察

2.3.1 PVP 修飾 Ag ナノ粒子の構造および物性評価

TEM 観察結果より、得られたナノ粒子は均一に分散しており、その平均粒子径は 23.7±3.3 nm であることが明らかとなった(図 2.2a)。また XRD 測定より、20=38°に Ag ナノ粒子の(111)面に由来するピークが観測されたことから、結晶性の Ag ナノ粒 子が形成されていることが確認できた(図 2.2b)。さらに、FT-IR 分析結果を図 2.3a に 示す。合成試料のスペクトルにて、2900 cm⁻¹付近に C-H の伸縮振動と 1660 cm⁻¹付近 に環状アミドの C=O 伸縮振動に由来するピークが確認でき、加えて 1400 cm⁻¹付近に ピロリジニル基の吸収ピークも観測されたことから、Ag ナノ粒子表面は PVP 分子に て修飾されていると考えられる。最後に、PVP 修飾 Ag ナノ粒子の光学特性を UV-vis 測定にて評価したところ、420 nm 付近の波長領域にて Ag ナノ粒子の表面プラズモン 共鳴に由来する吸収ピークが確認できた(図 2.3b)。



Figure 2.2. (a) TEM image and (b) XRD pattern of PVP-modified Ag NPs



Figure 2.3. (a) FT-IR spectrum and (b) UV-vis spectrum of PVP-modified Ag NPs

2.3.2 Ag ナノ粒子@MOF 複合体の構造および物性評価

合成試料の TEM 観察結果を図 2.4a に示す。Ag ナノ粒子表面上に厚み約 6.3 nm の シェルが被覆されていることが分かり、コア・シェル構造体の形成が確認できた。ま た XRD 測定より、得られた試料は Ag ナノ粒子由来のピークに加え、ZIF-8 に相当す る回折ピークを示したことから、形成されたコア・シェル構造体は Ag ナノ粒子なら びに ZIF-8 から構築されていることが明らかとなった(図 2.4b)。



Figure 2.4. (a) TEM image of the obtained Ag NP@ZIF-8 composites and (b) XRD patterns of resulting PVP-modified Ag NPs, ZIF-8, and Ag NP@ZIF-8 composites.



Figure 2.5. (a) UV-vis spectrum of resulting PVP-modified Ag NPs and Ag NP@ZIF-8 composites and (b) N_2 adsorption/desorption isotherm at 77 K of resulting ZIF-8 and Ag NP@ZIF-8 composites.

続いて、得られた複合体が Ag ナノ粒子および ZIF-8 の両性質を兼備した材料であ るかどうかを明らかとするため、UV-vis 測定にて Ag ナノ粒子の光学特性ならびに窒 素吸着測定にて ZIF-8 のガス吸着特性を評価した。まず UV-vis 測定結果を図 2.5a に 示す。得られた複合体は 450 nm 付近の波長領域に Ag ナノ粒子の表面プラズモン共 鳴由来の吸収ピークを示すことが確認でき、Ag ナノ粒子の光学特性は ZIF-8 形成後 も維持されていることが明らかとなった。この観測された吸収波長は、ZIF-8 被覆前 の Ag ナノ粒子が示すプラズモン共鳴吸収波長(420 nm)と比較してレッドシフトし ているが、これは Ag ナノ粒子表面を ZIF-8 で被覆することにより粒子表面の誘電率 が大きく変化したことに起因していると考えられる。続いて、窒素吸着測定にて本複 合体のガス吸着特性を評価したところ、ZIF-8 単体と同じガス吸着挙動を示すことが 確認でき(図 2.5b)、金属ナノ粒子の光学特性に加えて MOF の細孔特性を兼ね備えて いることが明らかとなった。

2.3.3 Ag ナノ粒子表面上での MOF 形成メカニズム

Ag ナノ粒子表面上での選択的 MOF 形成を志向した本アプローチの特徴は、ナノ粒 子表面を高分子で修飾することにより、MOF 前駆体である金属イオンを化学的に粒 子表面上にトラップすることのできるシステムを設計した点である。それにより、金



Figure 2.6. Time course analysis of the reaction for the formation of Ag NP@ZIF-8 composites; TEM images of the samples obtained after different reaction time.



Figure 2.7. TEM image of the Ag NP@ZIF-8 aggregations prepared by one-pot process.



Figure 2.8. Schematic illustration of the proposed approach (upper mechanism) for the construction of Ag NP@MOF core-shell structures. Selective self-assembly is induced by the localization of metal ions on the metal NP surfaces.

属イオンをあらかじめナノ粒子表面上に局在化させることが可能となり、続いて有機 配位子と反応させることで MOF の核形成ならびに結晶成長が粒子表面上に限定され、 結果、均一性の高い金属ナノ粒子@MOF コア・シェル構造体が形成されると考えられ る。そのため、本合成プロセスではまず始めに PVP 修飾 Ag ナノ粒子/硝酸亜鉛混合 溶液を調製し、30 分間撹拌することにより PVP 分子への亜鉛イオンの局在化を図っ た。その混合溶液を遠心分離することにより Ag ナノ粒子を採取して、ICP 測定にて

ナノ粒子表面に吸着した亜鉛イオンを定量したところ、仕込み量の約 90 %の亜鉛イ オンが PVP 分子に捕捉されていることが明らかとなった。続いて、有機配位子を加 えることにより粒子表面上での ZIF-8 形成を行い、その反応の経時変化を TEM 観察 にて評価した(図 2.6)。反応の初期段階(10-30分)では、Ag ナノ粒子と ZIF-8 から なる凝集体が観察された。これは系内に未反応の MeIM が大量に残っており、その未 反応物が反応溶液の冷却時に無秩序な凝集体形成をもたらしたと考えられる。反応時 間が 40 分のときは、ナノ粒子表面上にて ZIF-8 が形成されつつあるが、まだ多くの 凝集体が観察された。一方、50分反応させた際にはコア・シェル構造体の形成が確認 され、以降、反応時間の増大に伴い ZIF-8 のシェル厚が徐々に増大していることが明 らかとなった。加えて、ZIF-8 単体での結晶形成は全く生じていないことから、ZIF-8 前駆体は Ag ナノ粒子表面上で選択的に消費されていると考えられる。一方、亜鉛イ オンの局在化処理を施さず、Ag ナノ粒子分散溶液に ZIF-8 前駆体(硝酸亜鉛および MeIM)を同時に加えて複合体合成を行ったところ、コア・シェル構造体の形成は観 察されなかった(図 2.7)。これは、ZIF-8 がナノ粒子表面上だけでなく、溶液中で無 秩序に形成していることを示唆する結果である。以上の結果より、本手法では金属イ オンをトラップした金属ナノ粒子を MOF 成長の足場として用いることで、選択的な MOF 成長の実現を可能とした(図 2.8)。

2.3.4 Ag ナノ粒子@MOF 複合体の触媒特性

本項では、作製した複合体を触媒として用いてニトロフェノール類縁体の還元反応 を行うことにより、本複合体の触媒能を評価した結果について述べる。Ag ナノ粒子 はニトロ基の還元反応に対して触媒活性を示すことが知られており^[21]、今回は 4-ニ トロフェノールならびに 4-ニトロ-1-ナフトールを反応基質として用いることにより、 Ag ナノ粒子@ZIF-8 コア・シェル構造体の触媒活性ならびに分子ふるい効果について 評価した。まず、PVP 修飾 Ag ナノ粒子単体を触媒として用いて各基質の還元反応を 行ったところ、時間の経過に伴い 4-ニトロフェノール(400nm)および 4-ニトロ-1-ナ フトール(450 nm)に相当する吸収ピークは共に減少し、それに伴い 4-アミノフェノ ール(300 nm)と 4-アミノ-1-ナフトール(340 nm)由来の吸収ピークの増大が観測さ れたことから、Ag ナノ粒子は両基質に対して触媒活性を示すことが確認できた(図 2.9)。また、反応効率を比較すると、4-ニトロ-1-ナフトールの方が速く還元されてい



Figure 2.9. Changes in UV-vis absorption spectra during the reduction reaction of (a) 4nitrophenol and (b) 4-nitro-1-naphthol over PVP-Ag NPs as catalyst.



Figure 2.10. Conversion efficiency for the reduction reaction of 4-nitrophenol and 4-nitro-1-naphthol using PVP-Ag NPs as catalysts.

ることが明らかとなった(図 2.10)。これは、反応中間体であるラジカルアニオンの 安定性を考慮すると、より共役系の長い 4-ニトロ-1-ナフトールの方が電子の非局在 化が生じラジカルアニオンが形成されやすいため、4-ニトロフェノールよりも反応性 が高いと考えられる。続いて、Agナノ粒子@ZIF-8 複合体を触媒として用い還元反応 を行ったところ、本系も両基質に対して触媒活性を示すことが確認できた(図 2.11)。 特に、4-ニトロフェノールの還元反応に対して、複合体は Ag ナノ粒子単体を用いた 系とほぼ同等の反応速度を示したことから(図 2.12a)、Agナノ粒子の触媒活性は ZIF-8 被覆後も失活することなく維持されており、そして 4-ニトロフェノールは ZIF-8 細 孔内へのアクセスが可能であることが明らかとなった。一方、4-ニトロ-1-ナフトール



Figure 2.11. Changes in UV-vis absorption spectra during the reduction reaction of (a) 4nitrophenol and (b) 4-nitro-1-naphthol over Ag NP@ZIF-8 composites as catalyst.



Figure 2.12. Conversion efficiency for the reduction reaction of (a) 4-nitrophenol and (b) 4nitro-1-naphthol using PVP-Ag NPs and Ag NP@ZIF-8 composites as catalysts.

の還元反応に関して、その反応速度は Ag ナノ粒子単体を用いたときよりも大幅に低下していることが分かる(図 2.12b)。これは、分子サイズの大きい 4-ニトロ-1-ナフトールは ZIF-8 細孔内を拡散しにくく、Ag ナノ粒子表面にアクセスする速度が遅くなっていることが原因であると考えられる。以上の結果より、作製した Ag ナノ粒子 @ZIF-8 コア・シェル構造体は、Ag ナノ粒子の触媒活性ならびに MOF の分子ふるい 効果を兼ね備えていることが明らかとなった。しかしながら、4-ニトロ-1-ナフトール の分子サイズは ZIF-8 の細孔径よりも大きいため、本来なら 4-ニトロ-1-ナフトールの 還元反応は起こらないはずである。これは、曲率の大きなナノ粒子表面上でフレーム ワークが形成していることに加え、得られた MOF のシェル厚が薄いことから、MOF 膜には欠陥が生じていることが懸念され、MOF の分子ふるい効果を最大限に発揮す るには至っていないと考えられる。今後、金属ナノ粒子表面に効率的にアクセスでき、 かつ高い分子選択性を示すシェル厚の最適化を行い、これらの問題点をクリアするこ とで有機反応の新規触媒材料として有用になると考えられる。

2.4 まとめ

高分子修飾金属ナノ粒子表面上での選択的 MOF 形成、ならびに得られた金属ナノ 粒子@MOF 複合体の物性について評価し、以下の結論を得た。

1) 金属ナノ粒子表面を高分子である PVP 分子にて修飾することにより、MOF 前駆体 である金属イオンをあらかじめナノ粒子表面上に局在化させることが可能となり、続 いて有機配位子と反応させることで MOF の核形成・結晶成長がナノ粒子表面上に限 定されることが明らかとなった。

2) PVP 修飾 Ag ナノ粒子を用いても、金属イオンの局在化処理を施さずに複合体合成を行うと凝集体が形成されたことから、MOF の自己組織化サイトを特定位置に限定するためには金属イオンをその位置に局在化させることが重要であることが明らかとなった。

3) 作製した Ag ナノ粒子@ZIF-8 コア・シェル構造体は、Ag ナノ粒子の触媒特性および MOF の分子ふるい効果を兼ね備えており、分子サイズ選択性を有した触媒システムを提供することが可能である。

本研究では、あらかじめ金属イオンを局在化させておくことで MOF の反応サイト を特定位置に限定させるという極めてシンプルなアプローチにより、金属ナノ粒子表 面上での選択的 MOF 形成が可能であることを明らかにした。この本提案手法は、Ag ナノ粒子のみならず他の金属・半導体・磁性ナノ粒子、ならびに様々な MOF にも適 用可能であると期待でき、用途に合わせてナノ粒子@MOF 複合体の構造設計が可能 であることから高機能ナノ構造体合成のためのアプローチとして非常に有用である と考えられる。

2.5 参考文献

- K. Liang, R. Ricco, C. M. Dohertry. M. J. Styles, S. Bell, N. Kirby. S. Mudie, D. Haylock, A. J. Hill, C. J. Doonan, P. Falcaro, *Nature Communications* 2015, 6, no.7240
- 2. Y. Mao, J. Li, W. Cao, Y. Ying, L. Sun, X. Peng, ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 4473
- 3. K. K. Tanabe, Z. Wang, S. M. Cohen, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 8508
- 4. L. Ma, J. M. Falkowski, C. Abney, W. Lin, Nature Chemistry 2010, 2, 838
- 5. H. Sato, R. Matsuda, K. Sugimoto, M. Takata, S. Kitagawa, Nature Materials 2010, 9, 661
- T. V. Vu, H. Kosslick, A. Schulz, J. Harloff, E. Paetzold, H. Lund, U. Kragl, M. Schneider,
 G. Fulda, *Microporous and Mesoporous Mater.* 2012, 154, 100
- W.-W. Zhan, Q. Kuang, J.-Z. Zhou, X.-J. Kong, Z.-X. Xie, L.-S. Zheng, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 1926
- 8. F. Ke, L.-G. Qiu, Y.-P. Yuan, X. Jiang, J.-F. Zhu, J. Mater. Chem. 2012, 22, 9497
- 9. K. L. Kelly, E. Coronado, L. L. Zhao, G. C. Schatz, J., Phys. Chem. B 2003, 107, 668
- 10. S. Saha, A. Pal, S. Kundu, S. Basu, T. Pal, Langmuir 2010, 26, 2885
- 11. S. Wang, R. Gao, F. Zhou, M. Selke, J. Mater. Chem. 2004, 14, 487
- 12. K. Saha, S. S. Agasti, C. Kim, X. Li, V. M. Rotello, Chem. Rev. 2012, 112, 2739
- S. Hermes, M. K. Schröter, R. Schmid, L. Khodeir, M. Muhler, A. Tissler, R. W. Fischer, R. A Fischer, *Angew. Chem. Int. Ed.* 2005, 44, 6237
- H. L. Jiang, B. Liu, T. Akita, M. Haruta, H. Sakurai, Q. Xu, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 11302
- W. Zhang, G. Lu, C. Cui, Y. Liu, S. Li, W. Yan, C. Xing, Y. R. Chi, Y. Yang, F. Huo, *Adv. Mater.* 2014, 26, 4056
- 16. A. Dhakshinamoorthy, H. Garcia, Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 5262
- 17. F. Ke, L.-G. Qiu, Y.-P. Yuan, X. Jiang, J.-F. Zhu, J. Mater. Chem. 2012, 22, 9497
- A.-L. Li, F. Ke, L.-G. Qiu, X. Jiang, Y.-M. Wang, X.-Y. Tian, *CrystEngComm* 2013, 15, 3554
- 19. K. Khaletskaya, J. Reboul, M. Meilikhov, M. Nakahama, S. Diring, M. Tsujimoto, S. Isoda,

F. Kim, K. Kamei, R. A. Fischer, S. Kitagawa, S. Furukawa, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 10998

- 20. I. P. Santos, L. M. Liz-Marzan, Langmuir 1999, 15, 948
- 21. A. Gangula, R. Podila, R. M, L. Karanam, C. Janardhana, A. M. Rao, *Langmuir* **2011**, 27, 15268

第3章 金属ナノ粒子@*m*SiO₂ナノ構造体表面上での MOF 合成

3.1 はじめに

メソポーラスシリカ (mSiO₂) は、メソ孔 (孔径 2 - 50 nm) をもつナノ空間物質群 の代表であり、MOF のようなミクロポーラス材料では対応できないサイズの分子を 包接することができるホスト材料として注目を集めている。特に盛んに研究されてい る応用として、触媒担体・徐放材料・薬物輸送担体としての利用が挙げられる^[1-6]。し かしながら、mSiO₂は細孔径が比較的大きく物質の拡散性が高いため、担体として利 用する際には分子の流出・流入を抑制し、「閉じたナノ空間」を合目的に設計するこ とが重要となる。この課題に対して最も盛んに研究が行われているのは、有機分子や ポリマー修飾による細孔入口の制御である。これは、刺激応答性のある有機材料を利 用することにより、内包した機能性分子を特定条件下で放出させることが可能となる ため、薬物輸送担体として利用する際には極めて有用な手法である^[7-9]。このように、 分子の流出に関しては既に制御可能なシステムが確立されつつある。一方、mSiO₂を 触媒やセンサーの担体として利用する際には、色々なアウトプットを考慮してゲスト 分子に対する選択性、すなわち外部からの分子の流入を制御することが重要な課題と なる。mSiO₂細孔内へのゲスト分子のアクセス制御可能なシステムを確立することで、 触媒・センシング等の応用が飛躍的に展開することが期待できるが、現状、外部から



Figure 3.1. Schematic illustration of the proposed approach for the construction of Au NP@*m*SiO2@MOF three-phase structure.

の分子のアクセスを制御することのできるシステムはほとんど開発されていない。

そこで本研究では、MOF 形成の支持材料として mSiO₂に着目した。MOF は細孔サ イズを分子レベルで制御することが可能であるため、mSiO₂表面を MOF で被覆する ことにより mSiO₂細孔内へのゲスト分子のアクセスを高いレベルで制御することが できると考えられる。本章では、第2章にて行った高分子修飾金属ナノ粒子表面上で の選択的 MOF 成長プロセスを mSiO₂機能化金属ナノ粒子表面上での MOF 形成に展 開することで、金属ナノ粒子@mSiO₂@MOF 3 層構造体の作製を試みた(図 3.1)。さ らに、金属ナノ粒子@mSiO₂構造体表面上での MOF 成長の経時変化を観察すること により、コロイド界面での MOF の自己組織化プロセスに関する知見を得ることに成 功した。また、作製した 3 層構造体を構成している各材料の機能を評価することによ り、本複合体の応用性について検討した。

3.2 実験方法

3.2.1 mSiO2 機能化 Au ナノ粒子の合成

mSiO₂機能化 Au ナノ粒子は既報の手法を利用して合成した^[10,11]。まず、12.5 mM 臭 化ヘキサデシルトリメチルアンモニウム (Cetyltrimethyl ammonium bromide: CTAB) 混 合溶液 (水: エタノール = 5:2) 70 mL を調製した。このミセル溶液を 70 °C で加熱 しながら 13.4 mM 塩化金酸水溶液 (2.5 mL) を添加し、5 分後に 2.0 M 水酸化ナトリ ウム水溶液 (100 µL) を加えて 30 分間加熱することにより CTAB 修飾 Au ナノ粒子を 合成した。次いで、70 °C で加熱したまま 50 mL の蒸留水を加えて希釈した後、500 µL のオルトケイ酸テトラエチル (Tetraethyl orthosilicate: TEOS) を 5 分間隔で 50 µL ずつ添加した。添加終了後、2.0 M 水酸化ナトリウム水溶液 (400 µL) を加え、70 °C で 2 時間加熱することにより Au ナノ粒子表面上での SiO₂ 形成を行った。反応終了 後、過剰に存在している CTAB を除去するため、遠心分離 (8000 rpm, 10 分) および エタノール洗浄を 3 回行った。精製後、エタノール (120 mL) に再分散させ、1.0 mmol 硝酸アンモニウムを加えて 60°C で 20 分間加熱することにより CTAB の抽出を行っ た。抽出後、遠心分離 (8000 rpm, 10 分) およびメタノール洗浄を 3 回行うことで mSiO₂ 機能化 Au ナノ粒子を精製した。得られた Au ナノ粒子@mSiO₂ は、TEM, XRD, およ び窒素吸着測定にて評価した。
3.2.2 Au ナノ粒子@mSiO2@MOF 3 層構造体の作製

MOF には亜鉛イオンと MeIM から形成される ZIF-8 をターゲットとした。上記の プロセスにて合成した Au ナノ粒子@mSiO₂メタノール溶液(Au 含有量 6.4×10⁻¹³ mol, 1.25 mL)に、12.5 mM 硝酸亜鉛/25.0 mM MeIM 混合メタノール溶液(50 mL)を加え て 10 秒間撹拌した後、室温下で 12 時間静置させることにより ZIF-8 の合成を行った。 合成した試料は、遠心分離(4000 rpm, 5 分)およびメタノール洗浄を 3 回繰り返すこ とで精製した。得られた Au ナノ粒子@mSiO₂@ZIF-8 複合体は、TEM, SEM, XRD, お よび窒素吸着測定により評価した。

3.2.3 色素内包 Au ナノ粒子@mSiO2@MOF 3 層構造体の作製

10 mM ローダミン B (RB) /Au ナノ粒子@mSiO₂ 混合メタノール溶液 (1.25 mL) を 調製し、室温下で 1 時間静置させた。次いで、その混合溶液に 12.5 mM 硝酸亜鉛/25.0 mM MeIM 混合メタノール溶液 (50 mL) を加えて 10 秒間撹拌した後、室温下で 12 時 間静置させることで ZIF-8 の合成を行った。反応終了後、過剰に存在している RB を 除去するため、遠心分離 (8000 rpm, 10 分) およびエタノール洗浄を数回行った。ま た、同様のプロセスにてフルオレセイン内包 Au ナノ粒子@mSiO₂@ZIF-8 複合体の作 製も行った。それぞれ作製した色素内包 Au ナノ粒子@mSiO₂@ZIF-8 複合体は、TEM および分光蛍光光度計 (日本分光製 FP-6500 型) により評価した。

3.3 実験結果および考察

3.3.1 mSiO2機能化 Au ナノ粒子の構造および物性評価

合成試料の TEM 観察結果を図 3.2a に示す。直径 19.2 nm の Au ナノ粒子表面上に 厚み約 43.6 nm の mSiO₂が被覆されていることが分かり、分散性・均一性に優れた Au ナノ粒子@ mSiO₂コア・シェル構造体の形成が確認できた。また XRD 測定より、Au ナノ粒子の(111) 面に由来するピークに加えて、20=23°付近に mSiO₂のアモルファス 骨格に由来するピークが観測された(図 3.2b)。さらに IR 測定を行ったところ、1100 cm⁻¹付近に Si-O の伸縮振動由来のピークが確認でき、一方で CTAB に相当する吸収 ピークは観測されなかった(図 3.3a)。すなわち、得られた SiO₂構造体から有機鋳型 (CTAB)は除去されており、メソポーラス構造体が形成されていることが示された。



Figure 3.2. (a) TEM image and (b) XRD pattern of Au NP@mSiO₂ sphere.



Figure 3.3. (a) FT-IR spectra and (b) N₂ adsorption/desorption isotherm at 77 K of resulting Au NP@*m*SiO₂ sphere.

実際、窒素吸着測定にて Au ナノ粒子@mSiO2 構造体のガス吸着特性を評価したところ、メソ孔特有の IV 型吸着等温線を示すことが確認できた(図 3.3b)。

3.3.2 Au ナノ粒子@mSiO2@MOF 3 層構造体の構造および物性評価

TEM および SEM 観察結果より、Au ナノ粒子@mSiO2構造体は多結晶性 MOF によって均一に被覆されており、系統的に制御された3層構造体が構築されていることが



Figure 3.4. TEM and SEM images of obtained Au NP@mSiO₂@ZIF-8 structures. Red circle shows cavity generated between mSiO₂ and ZIF-8 phase.



Figure 3.5. XRD patterns of obtained Au NP@*m*SiO₂, Au NP@*m*SiO₂@ZIF-8 structures, and simulated ZIF-8.

確認できた(図 3.4)。さらに、XRD 測定より ZIF-8 由来の回折パターンが確認でき、 形成された 3 層構造体は Au ナノ粒子・mSiO₂構造体・ZIF-8 から構築されていること が明らかとなった(図 3.5)。その合成試料の XRD パターンにおいて、Au ナノ粒子に 相当するピーク強度は著しく弱いことが確認された。これは、複合体内における Au ナノ粒子の含有量が小さいことが原因であると考えられる。実際、ICP 測定にて複合 体内を占める Au ナノ粒子の割合を算出したところ、その重量比はわずか 1.2 wt%と 非常に小さいことが明らかとなった。また本実験系では、mSiO₂ 細孔内で MOF の錯 形成が起こることを懸念したため、第 2 章にて紹介した PVP 修飾 Ag ナノ粒子@ZIF-8 コア・シェル構造体の合成プロセスとは異なり、金属イオンの局在化処理を施さな かった。すなわち、one-pot 合成にて複合体の作製を行ったが、系内に存在する Au ナ



Figure 3.6. N₂ adsorption/desorption isotherm for Au NP@*m*SiO₂@ZIF-8 structures at 77 K. Inset shows hysteresis loop generated from the mesopores.

ノ粒子@mSiO₂構造体は全て ZIF-8 にて被覆されていることが確認できた。これは、 mSiO₂ 表面のシラノール基と金属イオン間の高い親和性が、mSiO₂ 表面上での ZIF-8 の核形成および結晶成長を誘発したと考えられる。一方、金属イオンの局在化処理を 行っていないため、溶液中での ZIF-8 単体の結晶形成も確認されたが、3 層構造体と ZIF-8 単体では重量が大きく異なるため、得られた試料を遠心分離にて精製すること により容易に3 層構造体のみを単離することが可能であった。

最後に、試料の細孔特性を評価するために窒素吸着測定を行った。得られた吸着/脱 着等温線は主にタイプ I 型の挙動、すなわち ZIF-8 由来の吸着/脱着挙動を示したが、 相対圧が 0.2-0.6 の範囲でわずかに mSiO₂ 由来の吸着/脱着プロファイル (IV 型)を示 していることが確認できた (図 3.6)。ICP 測定、TEM 観察、ならびに ZIF-8 と mSiO₂ の密度より、得られた 3 層構造体の各構成材料の重量分率を算出したところ、ZIF-8 が約 97 wt%を占め、mSiO₂ はわずか 2 wt% であることが明らかとなった。窒素吸着測 定は単位重量当たりの吸着量を評価しているため、得られた吸着/脱着プロファイル は複合体内での含有率が大きい ZIF-8 由来の吸着挙動を主に示し、含有率の小さい mSiO₂にもとづいた吸着挙動の変化は非常に小さいものになったと考えられる。また、 mSiO₂由来の吸着挙動の変化が小さい原因として、複合体の合成過程で mSiO₂細孔内 に ZIF-8 前駆体が充填されていることも考えられる。そのため、細孔分布測定を行う ことにより、作製した複合体が MOF 由来のミクロ孔と mSiO₂ 由来のメソ孔を兼ね備 えた材料であることを正確に評価する必要がある。

3.3.3 Au ナノ粒子@mSiO2 表面上での MOF 形成メカニズム

上記結果より、目的とした Au ナノ粒子@mSiO2@ZIF-8 3 層構造体が形成している ことが確認できたが、TEM 像(図 3.4)にて *m*SiO2 と ZIF-8 の間に明らかにコントラ ストの薄い部分(赤線で囲ってる部分)があり、空隙が生じていることが明らかとな った。そこで本項では、ZIF-8形成の経時変化を観察することにより、mSiO2表面上に おける ZIF-8 の結晶化プロセスについて評価した。その TEM 観察結果を図 3.7 に示 す。反応初期の10分の段階でAuNP@mSiO2構造体表面に丸みを帯びた結晶性の低い フレームワークが析出し、その結晶性の低い層は時間の経過と伴に増大していること が明らかとなった。一方、反応1時間後では複合体の最外層に角張ったフレームワー クが観察され、結晶性の高い ZIF-8 が形成し始めていることが分かる。そして、24時 間後には結晶性の高い ZIF-8 によって Au ナノ粒子@mSiO2 が完全に被覆されている ことが確認できた。mSiO2と ZIF-8 間の空隙に関しては3時間後に形成されているこ とが観察でき、その空隙は結晶化プロセスの進行に伴い除去に大きくなっていること が分かった。また、時間経過に伴う結晶化の進行に関しては XRD 測定からも支持さ れており(図 3.8)、これらの結果は結晶性の低いフレームワークから結晶性の高いフ レームワークへと相変化している過程で mSiO2と ZIF-8 の間に空隙が生じていること を示唆している。以上の結果をもとに、mSiO2表面上における ZIF-8 の成長メカニズ ムについて考察する。まず、反応初期に速度論的支配のもと結晶性の低いフレームワ ークが迅速に形成され、続いて反応の進行に伴い、熱力学的支配に基づいた結晶化プ ロセスが進行することにより結晶性の高いフレームワークが構築される。その過程で、 mSiO2表面に析出したフレームワークの歪み、ならびにアモルファス相と結晶相の密 度の違い等が起因して準安定な結晶相は一度溶解し、そして再配置することにより *m*SiO₂とZIF-8の間に空隙が形成されたと考えられる(図 3.9)。

35



Figure 3.7. Time course analysis of the reaction for the formation of Au NP@*m*SiO₂@ZIF-8 structures. Scale bars are 100 nm.



Figure 3.8. XRD patterns of Au NP@*m*SiO₂@ZIF-8 structures obtained after different reaction time.



Figure 3.9. Schematic illustration of the formation process of Au NP@*m*SiO2@MOF three-phase structure.

3.3.4 色素内包 Au ナノ粒子@mSiO2@MOF 3 層構造体の物性評価

最後に、作製した3層構造体の中間層である mSiO₂ と最外層である ZIF-8 の各材料 がもつ機能を明らかとすることにより、本複合体における細孔システムの有用性につ いて評価した。本実験にて各ポーラス材料に期待した機能は、mSiO₂のメソ孔を利用 した機能性分子の導入と MOF のミクロ孔を利用した分子ふるい効果である。まず、 機能性分子の導入に関しては蛍光色素である RB を用いて、RB 内包複合体の合成を 行った。得られた試料の TEM 観察結果より、RB を内包した Au ナノ粒子@mSiO₂構 造体表面上でも ZIF-8 の形成が確認できた (図 3.10)。その色素内包複合体の蛍光特 性を評価した結果を図 3.11 に示す。RB を内包していない複合体に関しては、可視紫 外光を照射しても発光しなかったのに対して、RB 内包複合体は黄色発光を示すこと



Figure 3.10. TEM image of RB-encapsulated Au NP@*m*SiO₂@ZIF-8 structures.



Figure 3.11. (a) Color change of the Au NP@mSiO₂@ZIF-8 structures with and without incorporation of RB under UV light irradiation. (b) Fluorescence spectra of RB solution and RB-encapsulated Au NP@mSiO₂@ZIF-8 structures.



Figure 3.12. (a) TEM image of ZIF-8 prepared in the presence of RB. (b) Photograph under UV light irradiation.

が確認できた。蛍光測定からも、RB 内包複合体は RB 由来の蛍光スペクトルを示す ことが観測された。一方、RB 存在下で合成した ZIF-8 単体は黄色発光を示さなかっ た(図 3.12)。これは、ZIF-8 が自身の細孔サイズよりも大きな RB を内包することが できないことを示しており、RB は 3 層構造体の中間層である mSiO₂の細孔内に内包 されていると考えられる。また、RB 内包複合体が示す発光波長は RB 本来の発光波 長よりもブルーシフトしているが、これは RB が mSiO₂ 細孔内に閉じ込められている ことにより分子振動が抑制されていることが原因であると考えられる^[12]。

続いて、Auナノ粒子@mSiO₂@ZIF-83 層構造体内に内包された RB の消光実験を行うことにより、最外層である ZIF-8 の分子ふるい効果について評価した。今回、RB の 消光を誘起する分子にはニトロメタンと 4-ニトロフェノールを利用した。まず、純粋



Figure 3.14. TEM images of fluorescein-encapsulated Au NP@ $mSiO_2@ZIF-8$ structures (a) before and (b) after the etching process of Au NPs. (c) Fluorescence spectra of fluorescein-encapsulated Au NP@ $mSiO_2@ZIF-8$ structures before and after the etching process of Au NPs.

なメタノール溶液中において、RB はニトロメタンおよび 4-ニトロフェノールに対し て同様の消光挙動を示すことを確認した。一方、複合体内に内包された RB は、ニト ロメタン存在下では消光したが、4-ニトロフェノール存在下ではほとんど消光しなか った図 3.13。これは、最外層である ZIF-8 の分子ふるい効果によって、細孔径より分 子サイズの小さいニトロメタンは ZIF-8 細孔内を拡散することができたが、細孔径と ほぼ同等のサイズである 4-ニトロフェノールは細孔内にほとんどアクセスできなか ったことを意味している。以上の結果から、作製した 3 層構造体は中間層である mSiO₂ の細孔を利用することにより機能性物質の導入が可能であり、加えて最外層の MOF は内包した物質の自発的な溶出を抑制するとともに、ゲスト分子のアクセスを制御する「ゲート」として機能することが明らかとなった。

また、TEM 観察ならびに蛍光測定結果より、本複合体はフルオレセインの内包も可能であることが確認できた(図 3.14)。フルオレセイン内包 Au ナノ粒子@mSiO₂@ZIF-8 3 層構造体は、517nm にフルオレセイン由来の発光ピークを示したが、その発光強 度は Au ナノ粒子をエッチングすることにより大幅に増大することが観測された(図 3.14c)。これは、Au ナノ粒子の表面プラズモン吸収バンドとフルオレセインの蛍光ス ペクトルがよく一致することに起因しており、複合体内に内包されていたフルオレセ インは Au ナノ粒子によって消光していたことを示す。すなわち、コア材料として利 用した Au ナノ粒子は複合体内に内包した色素の発光強度に影響を及ぼすことが明ら かとなった。

これら RB とフルオレセインの導入に基づいた一連の結果は、上項で言及した mSiO₂ と ZIF-8 間に存在する空隙に色素が取り込まれても同様のことが生じると考え られる。フルオレセインの発光が Au ナノ粒子によって消光されていることを考慮す ると、Au ナノ粒子近傍に色素が存在するため mSiO₂ 細孔内に取り込まれていると考 えられるが、mSiO₂ と ZIF-8 間の空隙に色素が全く存在しないとは言い切れない。こ の空隙は ZIF-8 の成長初期段階に生じるアモルファス層が原因であるため、ZIF-8 の 合成を加熱しながら行うことによりアモルファス層の形成を抑制でき、空隙のない Au ナノ粒子@mSiO₂@ZIF-8 3 層構造体を作製することが可能になると考えられる。 そのため今後、合成条件を最適化することにより空隙が存在しない 3 層構造体で同様 の応用を行い、空隙が 3 層構造体の物性に及ぼす影響について検討する必要がある。

3.4 まとめ

mSiO₂機能化 Au ナノ粒子表面上での MOF 形成、ならびに得られた Au ナノ粒子 @mSiO₂@ZIF-83層構造体の物性について評価し、以下の結論を得た。

mSiO₂ 表面のシラノール基と金属イオン間の高い親和性を利用することにより、
 mSiO₂機能化 Au ナノ粒子表面上で優先的に MOF を成長させることが可能であった。
 コロイド界面での結晶成長において、MOF はまず反応初期に速度論的支配のもと
 結晶性の低いフレームワークが形成される。反応の進行に伴いその不安定な結晶相は

一度溶解し、熱力学的支配に基づいて再結晶化することにより結晶性の高いフレーム ワークが形成されることが明らかとなった。

3) Au ナノ粒子@mSiO₂@ZIF-83 層構造体において、Au ナノ粒子は2種類のポーラス 材料で被覆されても本来のプラズモン特性を示すことが明らかとなった。さらに、中 間層である mSiO₂のメソ孔を利用することで機能性分子の導入が可能であり、最外層 である MOF のミクロ孔は包接分子の溶出を防ぐとともに、ゲスト分子のアクセスを 制御する「ゲート」として機能することを明らかとした。

本研究では、Au ナノ粒子@mSiO₂ ナノ構造体表面上での優先的 MOF 形成により、 系統的に制御された Au ナノ粒子@mSiO₂@MOF 3 層構造体を作製することに成功し た。この得られた複合体は各材料の機能が統合されており、センシングや触媒、医療 分野での応用において興味深い性能を示すことが期待できる。また本実験では、コロ イド界面での MOF の自己組織化プロセスに関する知見を得ることにも成功した。こ れらの成果は、MOF を機能性ユニットとしたナノ複合体材料の構造を設計する際の 重要な指針になると考えられる。

3.4 参考文献

- K. Feng, R. Y. Zhang, L. Z. Wu, B. Tu, M. L. Peng, L. P. Zhang, D. Zhao, C. H. Tung, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 14685
- 2. F. Tang, L. Li, D. Chen, Adv. Mater. 2012, 24, 1504
- Z. Zhang, L. Wang, J. Wang, X. Jiang, X. Li, Z. Hu, Y. Ji, X. Wu, C. Chen, *Adv. Mater*.
 2012, 24, 1418
- 4. J. Zhao, F. Gao, Y. Fu, W. Jin, P. Yang, D. Zhao, Chem. Commun. 2002, 752
- Y. D. Chiang, H. Y. Lian, S. Y. Leo, S. G. Wang, Y. Yamauchi, K. C. W. Wu, *J. Phys. Chem.* C 2011, 115, 13158
- 6. K. C. W. Wu, Y. Yamauchi, J. Mater. Chem. 2012, 22, 1251
- 7. C. Wu, C. Chen, J. Lai, J. Chen, X. Mu, J. Zheng, Y. Zhao, Chem. Commun. 2008, 2662
- 8. L. Xing, H. Zheng, Y. Cao, S. Che, Adv. Mater. 2012, 24, 6433
- X. Wu, Z. Wang, D. Zhu, S. Zong, L. Yang, Y. Zhong, Y. Cui, ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5, 10895

- 10. J. Croissant, J. I. Zink, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 7628
- 11. G. Xu, S. Liu, J. Peng, W. Lv, R. Wu, ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 2032
- J. Tu, N. Li, Y. Chi, S. Qu, C. Wang, Q. Yuan, X. Li, S. Qiu, *Mater. Chem. Phys.* 2009, 118, 273

第 4 章 高分子フィルム上での MOF 合成

4.1 はじめに

MOF は均一な細孔を有するという構造上の特徴より高いゲスト分子選択性を有す るため、薄膜化技術を確立することで工業的応用の幅が大きく広がると考えられる。 そのため、MOFの膜化(二次元基板表面上への MOFの固定化)に関する研究は、2005 年に Hermes らによって初めて報告されて以降、現在に至るまで増加し続けている^{[1-} ^{6]}。MOFの膜化のための最も一般的な手法は、SAMで機能化した基板表面上でのLbL 成長法である^[7-10]。第1章でも述べたが、この手法は基板を反応溶液(金属イオン溶 液および有機配位子溶液)に交互に浸漬させるというシンプルなプロセスであり、浸 漬回数によって容易に膜厚を制御することができるという特徴を持つ。他にも、有機 溶媒に溶解させた構成物質を水面上に展開し、圧力をかけて圧縮することにより形成 される結晶膜を一層ずつ基板に転写することで薄膜を得る Langmuir-Blodgett (LB) 法 が報告されている^[11,12]。しかし、これらの手法はMOF膜を一層ずつ析出させるため、 薄膜を得るためにかなりのプロセスおよび時間を要するという課題がある。この課題 に対して近年では、ポーラスアルミナや多孔性セラミックのような多孔性基板内に金 属イオンを吸着させ、その後反応を行うことにより MOF 膜を作製するという方法も 報告されている^[13-15]。この手法は短時間での合成が可能であるが、金属イオンが孔内 に物理的に吸着しており、吸着金属イオンの溶出速度を制御することができないため、 MOF の核形成・結晶成長は基板表面上で不均一に生じ、欠陥フリーな連続膜を形成 することが困難となる。したがって、以上の課題を解決する新たな手法の開発が待望 されている。

本研究では、MOF の成長サイトを高分子基板/反応溶液の界面に限定した新たな MOF 膜創製技術の開発に取り組んだ。第2章の研究成果より、MOF の自己組織化サ イトを特定位置に限定するためには、金属イオンをその位置に局在化させることが重 要であることを明らかとしている。本章では、この知見をもとに金属イオンを化学的 にドープした高分子フィルムを作製し、そのフィルム表面上での選択的 MOF 形成を 試みた(図 4.1)。本提案手法において、高分子フィルム内にドープさせた金属イオン の溶出は有機配位子のプロトンとのイオン交換反応に基づいている。すなわち、ドー プする金属イオン量ならびに有機配位子濃度を調整することにより、形成される



Figure 4.1. Schematic illustration of the proposed approach for the formation of MOF crystals on the polymer substrate.

MOF の膜厚および結晶成長速度を制御することが可能であると考えられる。そこで 本実験では、ドープする金属イオン量ならびに有機配位子濃度が MOF の膜厚および 成長速度に及ぼす影響について評価し、さらに有機配位子とドープする金属イオン種 を変えることにより異なる MOF 膜の形成についても検討を行った。

4.2 実験方法

4.2.1 金属イオンドープポリイミドフィルムの調製

ポリイミドフィルムは、東レ・デュポン社製カプトン 200-H(厚み 50 μm)を使用 した。まず、ポリイミドフィルムを 50 °C の 5 M 水酸化カリウム水溶液に所定時間浸 漬させることによりフィルムの表面改質を行った。続いて、表面改質処理後のポリイ ミドフィルムを 100 mM 塩化アルミニウム水溶液に浸漬させ、イオン交換反応により アルミニウム(III)イオンを吸着させた。この Al³⁺吸着ポリイミドフィルムを 10 vol% 硝酸水溶液に浸漬させることによりアルミニウムイオンを溶出させ、その溶出量を ICP にて定量することで吸着アルミニウムイオン量を算出した。

4.2.2 ポリイミドフィルム表面上での MOF 合成

MOF には、アルミニウムイオンとテレフタル酸 (H₂bdc) から構築される MIL-53(Al) ([Al(OH)(bdc)]_n)をターゲットとした。Al³⁺吸着ポリイミドフィルムを 6 mM H₂bdc 水溶液 (5 mL) に浸漬させ、マイクロウェーブ照射により 200 ℃ で 1 時間加熱する ことにより MIL-53(Al)の合成を行った。合成試料は SEM および XRD により評価し た。

4.2.3 ポリイミドフィルム表面上での異種 MOF 合成

MIL-53(Al)とは異なる種類の MOF として、アルミニウムイオンと 1, 4-ナフタレン ジカルボン酸 (H₂ndc) から構築される [Al(OH)(ndc)]_n、銅イオンとトリメシン酸 (H₃btc) から構築される HKUST-1 ([Cu₃btc₂]_n)、そして銅イオンと 2 成分の有機配位子 (H₂ndc と 1,4-ジアザビシクロ[2,2,2]オクタン (dabco)) から構築され、ピラードレイヤー構造 を有する[Cu₂(ndc)₂(dabco)]_nの合成を行った。各系ともに、ポリイミドフィルムの表面 改質は 50 ℃ の 5 M 水酸化カリウム水溶液で 5 分間行った。続いて、表面改質処理後 のポリイミドフィルムを 100 mM 塩化アルミニウム水溶液に浸漬させることにより Al³⁺を吸着させ、100 mM 酢酸銅水溶液に浸漬させることにより Cu²⁺を吸着させた。 [Al(OH)(ndc)]nは、Al³⁺吸着ポリイミドフィルムを 6 mM H₂ndc 水溶液(5 mL)に浸漬 させ、マイクロウェーブ照射により 150 ℃ で 2 時間加熱することにより合成した。 HKUST-1 は、Cu²⁺吸着ポリイミドフィルムを 10 mM H₃btc ブタノール溶液(5 mL)に 浸漬させ、マイクロウェーブ照射により 150 ℃ で 30 分間加熱することにより合成し た。最後に[Cu₂(ndc)₂(dabco)]_nは、Cu²⁺吸着ポリイミドフィルムを 10 mM H₂ndc/5 mM dabco 混合メタノール溶液(5 mL)に浸漬させ、マイクロウェーブ照射により 150 ℃ で30分間加熱することにより合成した。それぞれ作製した試料は、SEM および XRD により評価した。

4.3 実験結果および考察

4.3.1 ポリイミドフィルムの表面改質と金属イオンの吸着

ポリイミドフィルムは水酸化カリウム水溶液で処理することによりイミド環が開 裂し、アミド結合とカルボキシ基が形成される。すなわち、反応後はポリアミック酸 のカリウム塩の状態である。この表面改質後のポリイミドフィルムは、金属イオン溶 液に浸漬させることで、イオン交換反応により金属イオンを吸着させることが可能と なる。図 4.2 に水酸化カリウム処理時間に対する K⁺の吸着量ならびにイオン交換後の Al³⁺の吸着量の変化を示す。K⁺および Al³⁺の吸着量はともに改質時間に比例して増大 することが確認できた。これは、改質時間に比例して表面改質層の厚さが樹脂の深さ 方向に増大することに起因した結果である^[16]。また、各改質時間における Al³⁺の吸着 量は、K⁺の吸着量の約3分の1であることが明らかとなった(表 4.1)。これは、3 価 のアルミニウムイオンは1価カリウムイオンと化学両論的にイオン交換することに



Figure 4.2. Effect of KOH treatment time of polyimide film on the number of adsorbed metal ions. The error bars are based on the results of three times.

Table 4.1. Amount of K⁺ and Al³⁺ Ions Adsorbed by Different KOH Treatment Time.

Reaction time Doped-ions	1 min	2 min	3 min	4 min	5 min
K⁺ ions / nmol cm⁻²	565	1163	1573	2296	2795
Al ³⁺ ions / nmol cm ⁻²	185	354	513	726	906

よりポリイミドフィルム内に吸着していることを示している。したがって、ポリイミ ドフィルムの表面改質時間を調整することにより、金属イオンの吸着量を合目的に制 御することが可能である。

4.3.2 ポリイミドフィルム表面上での MOF 形成

改質時間 5 分の Al³⁺吸着ポリイミドフィルムを用いて合成を行った試料の SEM 観 察および XRD 測定結果を図 4.3 に示す。ポリイミドフィルム表面上に針状の結晶物 が析出していることが確認でき、さらに XRD 測定より、MIL-53(Al)に相当する回折 ピークならびにポリイミドフィルム由来のハローパターンが観測されたことから、ポ リイミドフィルム表面上に MIL-53(Al)が形成していることが明らかとなった。また、 SEM 写真では針状結晶が点在しているようにみられるが、断面写真よりポリイミド フィルム表面上に結晶が密に析出しており、連続的な結晶膜が形成していることが確 認できた。すなわち、大きな結晶の下に小さい結晶が密に詰まっていることが分かる。 これは、本プロセスでは MOF の核形成と結晶成長を独立して制御することができな いことに起因した結果であると考えられる。



Figure 4.3. (a) SEM images and (b) XRD pattern of obtained MIL-53(Al) films.

4.3.3 MOFの膜厚・成長速度に及ぼす吸着金属イオン量の影響

本手法では、金属イオン吸着ポリイミドフィルムを MOF の金属イオン源として利 用しているため、MOF の膜厚は吸着金属イオン量に依存すると考えられる。そこで 本項では、ポリイミドフィルムの表面改質時間を変化させて Al³⁺の吸着量を調整する



Figure 4.4. (a) Top view and (b) cross-sectional SEM images of MIL-53(Al) crystals prepared by using polyimide films over different hydrolysis time. Scale bares are 20 and 5 μ m (inset and cross-sectional images, respectively). (c) Thickness of the resulting MIL-53(Al) crystals as a function of the number of adsorbed Al³⁺ ions. The error bars are based on the results of three times.



Figure 4.5. Simulated and observed XRD patterns of MIL-53(Al) crystals prepared by using polyimide film over different hydrolysis times. ことにより、吸着金属イオン量が MOF の膜厚に及ぼす影響について検討した。まず、 各改質時間にて得られた試料の SEM 観察結果を図 4.4a,b に示す。いずれの条件にお いてもロッド状の MIL-53(Al)の析出が観察され、その析出量は改質時間の増大に伴い 明らかに増えていることが確認できた。さらに断面図より、その膜厚は改質時間が 1, 2,3,4,5 分と増えるにつれて、1.3,1.6,3.8,4.7,5.4 µm と増大し、これらの膜厚はポリ イミドフィルム内に吸着した Al³⁺が全て MIL-53(Al)形成に消費されたと仮定した際 の計算値とほぼ一致することが分かった (図 4.4c)。すなわち、吸着 Al³⁺は MIL-53(Al) 形成に消費され、かつその MOF 形成はポリイミドフィルム表面上で選択的に起こっ ていることが明らかとなった。また、改質時間を変化させた試料を XRD にて評価し たところ、各改質時間にて得られた試料は全て MIL-53(Al)由来の回折ピークを示し、 そのピーク強度は改質時間の増大に伴い大きくなっていることから、MOF の析出量 が増えていることが分かる (図 4.5)。

さらに、各改質時間の異なるポリイミドフィルムを用いて、反応時間の増大に伴う 膜厚の変化を観察することにより MIL-53(Al)の成長速度を評価したところ、Al³⁺の吸



Figure 4.6. (a) Variation in crystal thickness as a function of reaction time. (b) Crystal growth mechanism on the polymer substrate by proposed interfacial approach.

着量が多い系ほど成長速度は速いことが確認できた(図 4.6a)。これらの結果をもと に、本手法におけるポリイミドフィルム/反応溶液界面での MOF の成長プロセスを図 4.6b に示す。まず、有機配位子のプロトンとのイオン交換反応によりポリイミドフィ ルム表面近傍にドープされている金属イオンが溶出し、有機配位子と反応することに よりフィルム/反応溶液の界面にて均一に MOF の結晶核が生成される。それに伴いポ リイミドフィルム内で金属イオンの濃度勾配が生じ、それが駆動力となり吸着金属イ オンがフィルム表面近傍へと拡散移動することで MOF が連続的に成長するといった プロセスを経て均一な膜が形成される。すなわち、反応開始後は Al³⁺の吸着量が多い 系ほどポリイミドフィルム内に生じるイオンの濃度勾配が大きくなるため金属イオ ンの拡散速度は大きくなり、その結果、MOF の成長速度は速くなる。

4.3.4 MOFの膜厚・成長速度に及ぼす有機配位子濃度の影響

次いで、有機配位子濃度が MOF の膜厚および結晶成長速度に及ぼす影響について 検討した。ポリイミドフィルムの表面改質時間は5分で固定し、テレフタル酸濃度を 3.6, 4.8, 6.0 mM と変化させて合成を行った試料の SEM 観察結果を図 4.7 に示す。各



Figure 4.7. Top view and cross-sectional SEM images of MIL-53(Al) crystals prepared by using reaction solution containing different concentration of H₂bdc. Scale bars are 20 and 5 μ m (inset and cross-sectional images, respectively).



濃度条件下でロッド状の MIL-53(Al)の析出が観察され、その結晶サイズおよび膜厚は 濃度の増大に伴い明らかに大きくなっていることが確認できた。続いて、各濃度条件 下での反応時間の増大に伴う膜厚の変化を観察することにより MIL-53(Al)の成長速 度を評価した。その反応時間に対する膜厚の変化をプロットした結果を図 4.8 に示す。 低濃度(3.6 mM および 4.8 mM)条件下では、反応 1 時間後も徐々に膜厚が大きくな っており、12 時間後にようやく膜厚が 5 μm(吸着 Al³⁺が全て消費された際の膜厚) に達することが明らかとなった。一方、高濃度(6.0 mM)条件下では、1 時間以内で 劇的に膜厚が大きくなり、1 時間の段階でほぼ膜厚が 5 μm に達していることが分か った。ポリイミドフィルム内にドープされた金属イオンの溶出は有機配位子のプロト ンとのイオン交換反応にもとづいているため、その溶出速度は有機配位子濃度にも大 きく依存する。したがって、有機配位子濃度が大きい系では金属イオンの溶出速度が 速くなり、それに伴い MOF の成長速度も速くなったと考えられる。

以上、前項ならびに本項の結果より、ポリイミドフィルム表面上での MOF の結晶 成長速度はドープした金属イオンの溶出速度に依存していることが明らかとなった。 すなわち、本合成プロセスでは金属イオンの溶出速度が反応の律速段階であり、それ はドープする金属イオン量ならびに有機配位子濃度を調整することにより制御可能 である。

4.3.5 本手法の汎用性評価

それぞれポリイミドフィルム表面上で合成した[Al(OH)(ndc)]_n、HKUST-1、 [Cu₂(ndc)₂(dabco)]_nの SEM 観察ならびに XRD 測定結果を図 4.9 に示す。MIL-53(Al)と



Figure 4.9. SEM images and XRD patterns of the resulting $[Al(OH)(ndc)]_n$, HKUST-1, $[Cu_2(ndc)_2(dabco)]_n$ crystals.

は有機配位子のみが異なる[Al(OH)(ndc)]_n、金属イオン種と有機配位子がともに異なる HKUST-1 および[Cu₂(ndc)₂(dabco)]_n、全てのフレームワークがポリイミドフィルム表 面上で密に形成され、さらに高い結晶性を示すことが確認できた。すなわち本提案手 法は、有機配位子の種類ならびにドープする金属イオン種を変えることにより、様々 な MOF の膜化にも適用可能であることが明らかとなった。

4.4 まとめ

金属イオンドープ高分子フィルムの調製ならびにその表面上での選択的 MOF 形成 について検討し、以下の結論を得た。

 1) 有機配位子のプロトンとのイオン交換反応によりポリイミドフィルム表面近傍に ドープされている金属イオンが始めに溶出し、有機配位子と反応することによりフィ ルム/反応溶液の界面にて均一に MOF の結晶核が生成される。続いて、ポリイミドフ ィルム内に存在するイオンの濃度勾配を駆動力として金属イオンがフィルム表面近 傍へと拡散移動することにより MOF の結晶成長が進行し、連続膜が形成される。
 2) ポリイミドフィルム内にドープした金属イオンの溶出速度が反応の律速段階であ るため、ドープする金属イオン量ならびにリガンド濃度を調整することにより MOF の結晶成長速度を容易に制御することが可能である。

3)金属イオンドープポリイミドフィルムは MOF 形成の支持基板としてだけでなく、 金属イオン源としての役割も担っているため、金属イオンの吸着量を調整することに より MOF の膜厚を容易に制御することが可能である。

本研究では、金属イオンドープポリイミドフィルムを用いることにより MOF の成 長サイトを基板表面に限定させることを可能とし、連続性に優れた MOF 膜を得るこ とに成功した。さらに、その MOF 形成プロセスは吸着金属イオンと有機配位子のプ ロトンとのイオン交換反応に基づいており、その反応速度は容易に制御することが可 能である。すなわち、本提案手法は MOF 結晶成長の「速度論的制御」といった MOF 膜作製のための新しい方法論を創出するものである。加えて、本手法は様々なフレー ムワークにも適用可能であることから、本研究成果は未だ多くの問題を抱えている MOF 膜形成研究に一石を投じる革新的結果であるといえる。

4.5 参考文献

- S. Hermes, F. Schröder, R. Chelmowski, C. Wöll, R. A. Fischer, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 13744
- S. Aguado, C.-H. Nicolas, V. M.-Baslé, C. Nieto, H. Amrouche, N. Bats, N. Audebrand, D. Farrusseng, *New J. Chem.* 2011, 35, 41
- 3. Y. Pan, Z. Lai, Chem. Commun. 2011, 47, 10275
- 4. M. N. Shah, M. A. Gonzalez, M. C. McCarthy, H.-K. Jeong, Langmuir 2013, 29, 7896
- Z. Kang, M. Xue, L. Fan, J. Ding, L. Guo, L. Gao, S. Qiu, *Chem. Commun.* 2013, 49, 10569
- L. Heinke, M. Cakici, M. Dommaschk, S. Grosjean, R. Herges, S. Bräse, C. Wöll, ACS Nano 2014, 8, 1463
- S. Sakaida, K. Otsubo, O. Sakata, C. Song, A. Fujiwara, M. Takata, H. Kitagawa, *Nature Chemistry* 2016, 8, 377
- O. Shekhah, H. Wang, S. Kowarik, F. Schreiber, M. Paulus, M. Tolan, C. Sternemann, F. Evers, D. Zacher, R. A. Fischer, C. Wöll, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 15118
- 9. K. Kida, K. Fujita, T. Shimada, S. Tanaka, Y. Miyake, Dalton Trans. 2013, 42, 11128

- 10. J. Nan, X. Dong, W. Wang, W. Jin, N. Xu, Langmuir 2011, 27, 4309
- M. Tsotsalas, A. Umemura, F. Kim, Y. Sakata, J. Reboul, S. Kitagawa, S. Furukawa, J. Mater. Chem. 2012, 22, 10159
- J. Benito, S. Sorribas, I. Lucas, J. Coronas, I. Gascon, ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 25
- 13. J. Yao, D. Dong, D. Li, L. He, G. Xu, H. Wang, Chem. Commun. 2011, 47, 2559
- 14. H. T. Kwon, H.-K. Jeong, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 10763
- X. Wang, M. Sun, B. Meng, X. Tan, J. Liu, S. Wang, S. Liu, *Chem. Commun.* 2016, 52, 13448
- 16. K. Akamatsu, S. Ikeda, H. Nawafune, Langmuir 2003, 19, 10366

第5章 高分子フィルム上での MOF の配向制御

5.1 はじめに

MOF は様々な分子を選択的に細孔内に吸着させることが可能であるため、新奇な 吸着材・分離材としての応用が特に期待されているが、このような応用展開を目指す ためには MOF の薄膜化技術の開発が必須となる。また、MOF 膜の応用を考えた際、 その物性を左右する構造パラメーターとして、連続性・膜厚・結晶サイズ・配向が主 に挙げられる^[1-5]。なかでも、「結晶配向」は孔の向きを決定付け、ゲスト分子の拡散 速度や分離能に大きな影響を与えるため、MOF の結晶配向に関する情報は分離膜を 作製するうえで極めて重要である^[6-8]。しかしながら、MOF 膜は基板上で多数の結晶 が連続的に析出することで構築され、かつその MOF の自己組織化は基板に対する成 長指向性がないため、基本的にはランダムな配向の MOF 膜が形成される^[9-12]。その ため、MOFの結晶配向を制御するためには、その基板表面での MOF の自己組織化を 合目的に制御する必要がある。これに対して、現在、基板表面上での MOF 膜の結晶 配向制御に用いられている最も一般的な手法は、SAM で機能化した基板表面上での LbL 成長法に基づいたものである。この手法では、SAM を用いることにより金属イ オンが配位する向きを初めに固定することができ、その後に MOF を多段階的に成長 させることで配向の揃った MOF 膜を得ることが可能となる^[13-15]。この手法は汎用性 が高く、加えて配向の揃った異種 MOF 膜を作製することもできるため^[16]、画期的な アプローチであると言えるが、合成プロセスが煩雑であり多くの時間を要するといっ た問題点を抱えている。一方、MOF 膜の簡便な合成として、金属イオンをあらかじめ 多孔性基板にドープする手法が報告されているが[17,18]、物理吸着によるイオンドープ であるためその溶出を制御することはできず、MOF の自己組織化プロセスを制御す ることは困難である。したがって、MOFの自己組織化プロセスを精密に制御し、onepot 合成にて結晶配向を制御することは学術的に非常に興味深いことであるが、未だ 十分な成果は得られていない。

本研究の目的は、one-pot 系での結晶配向制御可能な新規 MOF 膜作製技術の提案で ある。本章ではその実証実験として、ピラードレイヤー構造をもつ[Cu₂(ndc)₂dabco]_n (ndc:1,4-naphthalenedicarboxylate, dabco:1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane)をターゲット とし、ポリイミドフィルム表面上での結晶配向制御を試みた。 [Cu₂(ndc)₂dabco]_n は、 Cu^{2+} と ndc が形成する paddle wheel 型二核クラスターからなる二次元レイヤーを、 dabco が架橋することで組み上がる異方性骨格をもつ MOF であるため、結晶の配向 性を評価するのに適した化合物である^[19]。第4章の研究成果より、金属イオンをドー プしたポリイミドフィルムを支持基板として用いることで、one-pot 合成で [Cu₂(ndc)₂(dabco)]_nの膜化が可能であることを明らかとしている。その成長プロセスは、 ポリイミドフィルム内にドープした銅イオンと H2ndc リガンドのプロトンとのイオ ン交換反応に基づいてまず二次元レイヤーが形成され、その後にピラー配位子である dabco が架橋することで三次元フレームワークが形成される。すなわち、one-pot 合成 でもレイヤー形成とピラー配位子の架橋を二段階に分けて制御することが可能であ り、反応初期に形成される二次元レイヤーの向きを制御することができれば、形成さ れる[Cu₂(ndc)₂(dabco)]n結晶膜の配向を揃えることができると考えられる(図 5.1)。そ こで本実験では、二次元レイヤーの向きを制御するためのファクターとしてポリイミ ドフィルムとレイヤー間の化学的相互作用に着目した。その化学的相互作用は、媒体 環境と二次元レイヤーの大きさ(ポリイミドフィルムとの接触面積)に依存すると考 えられるため、レイヤーリガンド(H2ndc)濃度を調整することでレイヤーサイズを 制御するとともに、極性の異なるアルコール溶媒中で合成を行うことにより結晶配向 を制御するためのパラメーターを明確化し、結晶配向制御可能なシステムの確立に取 り組んだ。



Figure 5.1. Schematic illustration of the strategy used for controlling the orientation of $[Cu_2(ndc)_2(dabco)]_n$ crystals on a polymer substrate.

5.2 実験方法

5.2.1 銅イオンドープポリイミドフィルムの調製

ポリイミドフィルムは、東レ・デュポン社製カプトン 200-H(厚み 50 µm)を使用 した。まず、ポリイミドフィルムを 50 ℃ の 5 M 水酸化カリウム水溶液に 5 分間浸漬 させることによりフィルムの表面改質を行った。続いて、表面改質処理後のポリイミ ドフィルムを 100 mM 水酸化銅水溶液に浸漬させ、イオン交換反応により銅(II)イ オンを吸着させた。

5.2.2 ポリイミドフィルム表面上でのピラードレイヤー型 MOF の配向制御

MOF には銅イオンならびにレイヤーリガンドである H2ndc とピラーリガンドであ る dabco から構築される [Cu2(ndc)2(dabco)]ⁿをターゲットとした。Cu²⁺吸着ポリイミ ドフィルムを所定濃度の H2ndc および dabco 混合メタノール溶液 (5 mL) に浸漬さ せ、マイクロウェーブ照射により 150 °C で 30 分間加熱することにより [Cu2(ndc)2(dabco)]ⁿの合成を行った。また、極性の異なるアルコール溶媒として、エタ ノール、プロパノール、およびブタノールを用い、それぞれの溶媒中にて同様の条件 下で[Cu2(ndc)2(dabco)]ⁿの合成を行った。合成試料は SEM および XRD により評価し た。また、結晶配向は XRD パターンにて、[Cu2(ndc)2(dabco)]ⁿのメインピークである ピラー面由来の(100)面とレイヤー面由来の(001)面のピーク強度比から評価した。

5.3 実験結果および考察

5.3.1 メタノール溶液中で合成した[Cu₂(ndc)₂(dabco)]_nの結晶配向

10 mM H₂ndc, 5 mM dabco の条件下で合成した試料の SEM 観察結果を図 5.2a に示 す。ポリイミドフィルム表面上に[Cu₂(ndc)₂(dabco)]_nの特徴的な正方結晶が密に析出し ていることが確認できた。また XRD 測定より、[Cu₂(ndc)₂(dabco)]_nに相当する回折ピ ークならびにポリイミドフィルム由来のハローパターンが観測され、ポリイミドフィ ルム表面上で[Cu₂(ndc)₂(dabco)]_nが形成されていることが明らかとなった(図 5.2b)。 しかし、その得られた試料の回折パターンは、シミュレーションパターンと比較して (100)面に対する(001)面のピーク強度比 (*I*₍₀₀₁₎/*I*₍₁₀₀₎)が明らかに大きいことが分かる。 得られた結晶の形態が正方結晶であることを考慮すると、これは[001]面配向の MOF



Figure 5.2. (a) SEM image and (b) experimental and simulated XRD patterns of $[Cu_2(ndc)_2(dabco)]_n$ crystals and polyimide film.



Figure 5.3. (a) XRD patterns and relative peak intensities, $I_{(001)}/I_{(100)}$, with respect to the H₂ndc concentration, and (b) SEM images of [Cu₂(ndc)₂(dabco)]_n crystals obtained at H₂ndc concentration of 1-40 mM. The concentration of dabco ligand was fixed at 5 mM.



Figure 5.4. Schematic illustration of the mechanism for formation of 2-D layers with different size by changing the H₂ndc concentration.

膜が形成されたと考えられ、反応初期段階にレイヤーは基板に対して平行状態で形成 したことを示唆する。

続いて、この [001]面配向を誘発する合成パラメーターとして、レイヤーリガンド である H₂ndc の濃度に着目した。ピラーリガンドである dabco の濃度は 5 mM で固定 し、H₂ndc 濃度を 1-40 mM の範囲で調整して合成を行った結果を図 5.3 に示す。図 5.3a より、H₂ndc 濃度の増大に伴い *I*₍₀₀₁₎/*I*₍₁₀₀₎は徐々に大きくなっていることが分かる。 また、H₂ndc 濃度の増大に伴い[Cu₂(ndc)₂(dabco)]_nの結晶サイズは大きくなっているが、 結晶形態は全て立方体で維持されていることが確認できた(図 5.3b)。すなわち、こ の*I*₍₀₀₁₎/*I*₍₁₀₀₎の増大は、H₂ndc 濃度が高くなるにつれ[001]面配向の MOF 結晶がより多 く形成されていることを示唆する。また本プロセスでは、ポリイミドフィルム内にド ープした銅イオンと H₂ndc リガンドのプロトンとのイオン交換反応にもとづいて二 次元レイヤーが形成されるため、H₂ndc 濃度の増大は金属イオンの溶出速度を速くし、 よりサイズの大きいレイヤー形成を誘発することを明らかとしている(図 5.4)^[20]。 したがって、H₂ndc 濃度が高くサイズの大きい二次元レイヤーが形成される条件下で、 [001]面配向の[Cu₂(ndc)₂(dabco)]_n 結晶がより優先的に形成されることが明らかとなっ た。

5.3.2 ブタノール溶液中で合成した[Cu2(ndc)2(dabco)]nの結晶配向

溶媒の極性はポリイミドフィルムと二次元レイヤー間の化学的相互作用に影響を 及ぼすため、溶媒を変えることにより反応初期に形成される二次元レイヤーの向きも 変化することが考えられる。そこで本項では、メタノールと同じアルコール溶媒であ るが、極性の低いブタノールを用いて[Cu2(ndc)2(dabco)],の合成を行った結果について



Figure 5.5. (a) SEM image and (b) experimental and simulated XRD patterns of $[Cu_2(ndc)_2(dabco)]_n$ crystals and polyimide film.



Figure 5.6. (a) XRD patterns and relative peak intensities, $I_{(100)}/I_{(001)}$, with respect to the H₂ndc concentration, and (b) SEM images of [Cu₂(ndc)₂(dabco)]_n crystals obtained at H₂ndc concentration of 1-20 mM. The concentration of dabco ligand was fixed at 5 mM.

述べる。まず、10 mM H₂ndc, 5 mM dabco の条件下で合成した試料の XRD 測定結果を 図 5.5a に示す。メタノール溶液中で合成した試料とは対照的に、シミュレーションパ ターンと比較して(001)面に対する(100)面のピーク強度比 ($I_{(100)}/I_{(001)}$)が大きくなっ ていることが分かる。また SEM 観察結果より、得られた[Cu₂(ndc)₂(dabco)]_nの結晶形 態はプレート状であることが明らかとなった (図 5.5b)。これは、結晶が[100]面方向 に優先的に成長したことを意味する。すなわち、シミュレーションパターンと比較し て $I_{(100)}/I_{(001)}$ が大きいのは、[100]面配向の MOF 膜が形成されたこととプレート状の 結晶が形成されたことの2つの要因が考えられる。

続いて、ブタノール溶液中でレイヤーリガンド(H2ndc)濃度が結晶配向に及ぼす 影響について評価した。dabcoの濃度は5 mM で固定し、H2ndc 濃度を 1-20 mM のレ ンジで調整して合成を行った結果を図 5.6 に示す。図 5.6a より、H2ndc 濃度の増大に 伴い I(100)/I(001)が大きくなっていることが分かる。さらに図 5.6b より、結晶形態は全 てプレート状であり、H2ndc 濃度の増大に伴い[Cu2(ndc)2(dabco)],の結晶サイズが等方 的に大きくなっていることが確認できた。本来、この結晶サイズの等方的な増大は、 強度比は一定のままピーク強度のみ増大させるはずである。したがって、H2ndc 濃度 の増大に伴う I(100)/I(001)の増大は、H2ndc 濃度が高くなるにつれ[100]面配向の [Cu2(ndc)2(dabco)],結晶が多く形成されていることを示唆する。また SEM 観察結果よ り、H2ndc 濃度の低い(1,5 mM)条件下で合成した試料は、析出した結晶数が少なく 疎な状態であることが確認された。これは、H2ndc 濃度が低いことに加え、ブタノー ル溶液中での金属イオンの溶解度が低いため、ドープした金属イオンの溶出速度が遅 いことが原因であると考えられる。したがって、ブタノール溶液中では、H2ndc 濃度 が高く初期に結晶核が多く形成される条件下で、[100]面配向の[Cu2(ndc)2(dabco)],結 晶が優先的に形成されることが明らかとなった。

5.3.3 溶媒の極性が[Cu₂(ndc)₂(dabco)]_nの結晶配向に及ぼす影響

上記結果より、メタノール溶液中で合成を行うと[001]面配向の[Cu₂(ndc)₂(dabco)]ⁿ 結晶が優先的に形成され、ブタノール溶液中では[100]面配向の[Cu₂(ndc)₂(dabco)]ⁿ 結 晶が優先的に形成されることが明らかとなった。そこで、溶媒の極性が結晶配向に及 ぼす影響をより詳細に評価するため、メタノールとブタノールの混合溶媒、ならびに エタノールおよびプロパノール溶液中での[Cu₂(ndc)₂(dabco)]ⁿ の合成を行った。

まず、メタノールとブタノールの混合溶媒中で合成した試料の XRD 測定結果を図 5.7a に示す。ピーク強度比(*I*(001)/*I*(100))は、メタノール含有量の減少に伴い徐々に低 下していることが確認できた。また、メタノール:ブタノールが 2:3 および 1:4 のとき は、シミュレーションパターンのピーク強度比と同程度であることからランダムな配 向を示しており、そしてブタノールのみの条件下で [100]面配向を示すことが分かっ た。すなわち、より極性の高い条件下では[001]面配向の結晶が優先的に形成され、極 性の低い条件下でのみ[100]面配向の結晶が形成されることが明らかとなった。また



Figure 5.7. (a) XRD patterns and relative peak intensities, $I_{(001)}/I_{(100)}$, with respect to the mixed solvent, and (b) SEM images of $[Cu_2(ndc)_2dabco]_n$ crystals obtained in different solvent compositional ration. The concentration of H₂ndc and dabco ligands is 20 and 5 mM, respectively.

SEM 観察結果より、得られた[Cu₂(ndc)₂(dabco)]_nの結晶サイズはメタノール含有量の 減少に伴い小さくなっていることが分かる(図 5.7b)。これは、ブタノール含有量が 増えるにつれ、ポリイミドフィルム内にドープした金属イオンの溶出速度が遅くなる ことが原因であると考えられる。

続いて、エタノールおよびプロパノール溶液中で合成した試料の XRD 測定結果を 図 5.8a に示す。メタノールからエタノールに溶媒を変えることによりピーク強度比 (*I*₍₀₀₁)/*I*₍₁₀₀₎)は劇的に低下し、次いでプロパノール、ブタノールとアルキル鎖が長く なるにつれ徐々に小さくなることが分かった。また、エタノールおよびプロパノール 溶液中で合成した試料のピーク強度比は、シミュレーションパターンのピーク強度比 と同程度であることからランダムな配向を示していることが分かる。これらの結果は、 メタノールとブタノールの混合溶媒を用いた際に得られた結果とよく一致しており、 より極性の高いメタノール溶液中でのみ[001]面配向の結晶が優先的に形成され、より 極性の低いブタノール溶液中でのみ[100]面配向の結晶が優先的に形成されることが



Figure 5.8. (a) XRD patterns and relative peak intensities, $I_{(001)}/I_{(100)}$, with respect to the polarity of alcohol solvent, and (b) SEM images of $[Cu_2(ndc)_2dabco]_n$ crystals obtained in different s alcohol solvent. The concentration of H₂ndc and dabco ligands is 20 and 5 mM, respectively.

明らかとなった。また、SEM 観察結果もメタノールとブタノールの混合溶媒を用いた 系と同様、極性が低くなるにつれ [Cu₂(ndc)₂(dabco)]_nの結晶サイズは小さくなること が確認できた(図 5.8b)。

以上、メタノールとブタノールの混合溶媒、ならびにエタノールおよびプロパノー ルを用いた実験結果から、アルコール溶媒の極性を調整することにより [Cu2(ndc)2(dabco)]ⁿの結晶配向制御が可能であることが明らかとなった。

5.3.4 [Cu₂(ndc)₂(dabco)]ⁿの反応経時変化の観察

本項では、SEM 観察ならびに XRD 測定により [Cu₂(ndc)₂(dabco)]_nの成長プロセス を評価した。まず、メタノール溶液中での反応経時変化の観察結果を図 5.9 に示す。 SEM 観察結果より、反応初期の 5 分の段階で既に結晶が密に析出し、その後は反応 の経過に伴い結晶サイズのみが等方的に大きくなっていることが確認できた(図 5.9a)。そのため、各反応時間にて得られた試料のピーク強度比(*I*₍₀₀₁₎ / *I*₍₁₀₀₎)に変化 はなかった(図 5.9b)。一方、ブタノール溶液中ではポリイミドフィルム内にドープ した金属イオンの溶出速度が遅いため、反応 5 分の初期段階に形成された結晶数は少 なく、反応 10 分後も結晶数は増えていることが明らかとなった。10 分以降は、結晶 サイズのみが等方的に大きくなっていることが確認できた(図 5.10a)。したがって、



Figure 5.9. (a) SEM images and (b) XRD patterns and relative peak intensities, $I_{(001)}/I_{(100)}$, of $[Cu_2(ndc)_2dabco]_n$ crystals obtained at different reaction times of 5-30 min. The concentration of H₂ndc and dabco ligands is 20 and 5 mM, respectively.



Figure 5.10. (a) SEM images and (b) XRD patterns and relative peak intensities, $I_{(100)}/I_{(001)}$, of $[Cu_2(ndc)_2dabco]_n$ crystals obtained at different reaction times of 5-30 min. The concentration of H₂ndc and dabco ligands is 20 and 5 mM, respectively.

10 分後に得られた試料のピーク強度比(*I*(100)/*I*(001))は、5 分後に得られた試料よりも わずかに大きくなっており、そして 30 分後の試料とは同程度であることが確認でき た(図 5.10b)。また、メタノールおよびブタノール溶液中で合成した試料はともに反 応初期の 5 分の段階で、それぞれ[001]面配向ならびに[100]面配向を示すことが明ら かとなった。すなわち、メタノール溶液中では反応初期に基板に対して平行状態の二 次元レイヤーが形成し、一方、ブタノール溶液中では基板に対して垂直状態の二次元 レイヤーが形成された後、ピラー配位子が架橋することで結晶成長することにより [001]面配向ならびに[100]面配向の[Cu₂(ndc)₂(dabco)]_n結晶が生成されたと考えられる。

5.3.5 [Cu₂(ndc)₂(dabco)]_nの結晶配向制御のメカニズム

第1-4項の実験結果をもとに、本手法における結晶配向制御のメカニズムについて 考察する。まず、溶媒の極性が結晶配向に及ぼす影響であるが、これはポリイミドフ ィルムと二次元レイヤー間の化学的相互作用に起因したものであると推測している。 ポリイミドフィルムは多数の芳香環を有しており、二次元レイヤーは H2ndc リガンド のナフタレン骨格から形成されていることから、ポリイミドフィルムと二次元レイヤ 一間には π-π 相互作用が主に作用していると予想される。このスタッキング相互作用 は極性の高い条件下でより強く作用するため、溶媒にメタノールを用いた際はポリイ ミドフィルムとレイヤー間の相互作用が強くなる。その結果、レイヤーは基板に対し て平行状態で形成されやすくなり、 [001]配向の[Cu2(ndc)2(dabco)]n 結晶が優先的に得 られたと考えられる。一方、極性の低いブタノール溶液中では、スタッキング相互作 用は強く作用しない。そのため、レイヤーは基板上でランダムまたは垂直状態で形成 されやすくなり、[001]配向の[Cu₂(ndc)₂(dabco)]_n 結晶が優先的に得られたと考えられ る(図 5.11a)。この溶媒の効果に加えて、レイヤーリガンド(H2ndc)の濃度も結晶配 向に影響を与えることが上記結果より明らかとなっている。本合成プロセスでは、 H2ndc 濃度の増大に伴いポリイミドフィルム内にドープした金属イオンの溶出速度は 速くなり、サイズの大きい二次元レイヤーが密に形成される。メタノール溶液中では、 サイズの大きいレイヤーが形成されることによりポリイミドフィルムとの接触面積 が増えるため、レイヤーは平行状態で形成されやすくなり、H2ndc 濃度の高い条件下 でより優先的に[001]配向の[Cu₂(ndc)₂(dabco)]n結晶が得られたと考えられる。一方、ブ タノール溶液中では、レイヤーが密に形成されることによりレイヤー間の相互作用が



Figure 5.11. Schematic representations of the mechanism for the growth of highly oriented $[Cu_2(ndc)_2dabco]_n$ crystals in a one-pot reaction by controlling of (a) chemical interactions between the framework components and polyimide film and (b) H₂ndc concentration.
強く働き、レイヤーは基板上にて垂直状態で形成されやすくなるため、H2ndc 濃度の 高い条件下でより優先的に[100]配向の[Cu2(ndc)2(dabco)]_n 結晶が得られたと推測され る(図 5.11b)。

5.4 まとめ

金属イオンドープ高分子フィルム上での MOF の結晶配向制御について検討し、以下の結論を得た。

1) ポリイミドフィルム内にドープした金属イオンと有機リガンドとのイオン交換反応が結晶成長のトリガーである本手法を用いることにより、one-pot 合成で [Cu2(ndc)2(dabco)]nの結晶配向を制御することに成功した。

2) 溶媒の極性を調整することによりフィルム/レイヤー間の相互作用の強さを調整することができ、反応初期に形成されるレイヤーの向きを制御することが可能であった。
 3) レイヤーリガンド(H₂ndc) 濃度を調整することにより、より優先的に[001]ならびに[100]配向の MOF 膜を作製することが可能であった。

本研究では、金属イオンドープポリイミドフィルムを用いることにより MOF 膜の 結晶配向制御に成功した。本手法は、基板と MOF 構成要素間の化学的相互作用およ びドープした金属イオンの溶出速度という極めてシンプルな合成パラメーターに基 づいたものであり、従来は困難であった one-pot 合成での結晶配向制御を可能とした。 この本成果は、結晶配向の揃った MOF 膜を作製する際の新たな設計指針となりえ、 学術的に非常に意義深いものである。

5.5 参考文献

- 1. Y.-S. Li, H. Bux, A. Feldhoff, G.-L. Li, W.-S. Yang, J. Caro, Adv. Mater. 2010, 22, 3322
- S. Hurrle, S. Friebe, J. Wohlgemuth, C. Wöll, J. Caro, L. Heinke, *Chem. Eur. J.* 2017, 23, 2294
- M.C. So, S. Jin, H.-J. Son, G. P. Wiederrecht, O. K. Farha, J. T. Hupp, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 15698
- 4. N. Campagnol, T. V. Assche, T. Boudewijns, J. Denayer, K. Binnemans, D. D. Vos, J.

Fransaer, J. Mater. Chem. A 2013, 1, 5827

- P. Falcaro, K. Okada, T. Hara, K. Ikigaki, Y. Tokudome, A. W. Thornton, A. J. Hill, T. Williams, C. Doonan, M. Takahashi, *Nature Materials* 2017, 16, 342
- 6. Y. Liu, G. Zeng, Y. Pan, Z. Lai, J. Membrane Sci. 2011, 379, 46
- 7. B. Liu, M. Tu, R. A. Fischer, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 3402
- S.-M. Chen, M. Liu, Z.-G. Gu, W.-Q. Fu, J. Zhang, ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 27332
- A. A. Talin, A. Centrone, A. C. Ford, M. E. Foster, V. Stavila, P. Haney, R. A. Kinney, V. Szalai, F. ElGabaly, H. P. Yoon, F. Léonard, M. D. Allendorf, *Science*. 2014, 343, 66
- J. Cravillon, S. Münzer, S.-J. Lohmeier, A. Feldhoff, K. Huber, M. Wiebcke, *Chem. Mater.* 2009, 21, 1410
- A. J. Brown, N. A. Brunelli, K. Eum, F. Rashidi, J. R. Johnson, W. J. Koros, C. W. Jones, S. Nair Science. 2014, 345, 72
- 12. Y. Yoo, Z. Lai, H. K. Jeong, Microporous and Mesoporous Mater. 2009, 123, 100
- O. Shekhah, H. Wang, D. Zacher, R. A. Fischer, C. Wöll, *Angew. Chem. Int. Ed.* 2009, 48, 5038
- B. Liu, O. Shekhah, H. K. Arslan, J. Liu, C. Wöll, R. A. Fischer Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 807
- K. Otsubo, T. Haraguchi, O. Sakata, A. fujiwara, H. Kitagawa, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 9605
- M. Meilikhov. S. furukawa, K. Hirai, R. A. Fischer, S. Kitagawa, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 341
- 17. J. Yao, D. Dong, D. Li, L. He, G. Xu, H. Wang, Chem. Commun. 2011, 47, 2559
- 18. H. T. Kwon, H.-K. Jeong, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 10763
- 19. R. Kitamura, F. Iwahori, R. Matsuda, S. Kitagawa, Y. Kubota, M. Takata, T. C. Kobayashi
- T. Tsuruoka, K. Mantani, A. Miyanaga, T. Matsuyama, T. Ohhashi, Y. Takashima, K. Akamatsu, *Langmuir* 2016, 32, 6068

第6章 高分子フィルム上での MOF の結晶成長プロセスの制御

6.1 はじめに

第4章ならびに5章にて得られた成果から、金属イオンドープ高分子フィルムを用 いた本手法は、one-pot合成で均一性の高いMOF連続膜を作製することが可能であり、 加えて合成条件を最適化することで膜厚ならびに結晶配向の制御も可能であること から、非常に有用なMOF膜作製手法であるといえる。しかしながら、高分子フィル ム内にドープした金属イオンの溶出は有機配位子のプロトンとのイオン交換反応に 基づいているため、カルボキシ基のようなイオン交換基をもつリガンドから構築され るフレームワークに対しては高い汎用性を示すが、イオン交換基をもたない有機配位 子から構築される MOF には適用できないといった課題を抱えている。

そこで本研究では、本提案手法が窒素ドナー性配位子のようなイオン交換基をもた ないリガンドから構築されるフレームワークにも適用できるよう、金属イオンドープ ポリイミドフィルム表面上で MOF の結晶成長を合目的に制御することのできるプロ セスを確立することを目的とした。具体的には、モジュレーターを用いることにより



Figure 6.1. Schematic illustration of the strategy used for the formation of ZIF-8 crystals on a metal ion-doped polymer substrate.

ドープした金属イオンの溶出速度と MOF の成長速度を独立して制御することのでき るシステムの確立を目指した。その実証実験として、ドープした金属イオンの溶出を 促すモジュレーターには硝酸ナトリウムを利用し、そして MOF にはイオン交換基を もたない有機配位子である MeIM と亜鉛イオンから構築される ZIF-8 をターゲットと し、ポリイミドフィルム上での合成を試みた。MeIM はイオン交換基をもたないため ドープした金属イオンの溶出を誘発することはできず、一方、硝酸ナトリウムは ZIF-8 の結晶形成には影響を及ぼさないことが分かっている。すなわち本合成プロセスで は、硝酸ナトリウム濃度は金属イオンの溶出速度のみに関与し、有機配位子の濃度は 溶出してきた金属イオンとの反応速度のみに関与するシステムとなっており、それぞ れを独立して制御することが可能である (図 6.1)。そのため、MOF の核形成速度な らびに結晶成長速度を合目的に制御することが可能になると考えられ、本章では、硝 酸ナトリウムおよび MeIM の濃度が ZIF-8 の結晶形成速度に及ぼす影響について系統 的に評価した。

6.2 実験方法

6.2.1 亜鉛イオンドープポリイミドフィルムの調製

ポリイミドフィルムは、東レ・デュポン社製カプトン 200-H(厚み 50 μm)を使用 した。まず、ポリイミドフィルムを 50 °C の 5 M 水酸化カリウム水溶液に 5 分間漬さ せることによりフィルムの表面改質を行った。続いて、表面改質処理後のポリイミド フィルムを 100 mM 硝酸亜鉛水溶液に浸漬させ、イオン交換反応により亜鉛(II)イ オンを吸着させた。

6.2.2 ポリイミドフィルム表面上での ZIF-8 合成

MOF には、亜鉛イオンと MeIM から構築される ZIF-8 をターゲットとした。 Zn^{2+} 吸着ポリイミドフィルムを所定濃度の NaNO₃および MeIM を含んだメタノール/H₂O 混合溶媒 1 L(混合比 1:1)に浸漬させ、室温下で 72 時間撹拌することにより ZIF-8 の合成を行った。合成試料は SEM および XRD により評価した。

6.3 実験結果および考察

6.3.1 ポリイミドフィルム表面上での ZIF-8 合成

100 mM NaNO3 および 500 mM MeIM の条件下で合成した試料の SEM 観察結果を図 6.2a に示す。ポリイミドフィルム表面上に ZIF-8 の特徴的な菱形 12 面体構造の結晶 が密に析出していることが確認できた。また XRD 測定より、ZIF-8 に相当する回折ピ ークならびにポリイミドフィルム由来のハローパターンが観測されたことから、ポリ イミドフィルム表面上で ZIF-8 が形成されていることが明らかとなった(図 6.2b)。 さらに、その反応経時変化を SEM にて観察した結果を図 6.3 に示す。反応時間が1時 間までは結晶の析出数が増大していることが分かり、1時間以降は時間の経過に伴い 結晶サイズが大きくなっていることが観察された。実際、1 mm² 当たりに析出した結 晶数ならびに結晶サイズを算出したところ、結晶数は1時間後まで増大し続けている ことが確認できた(図 6.4a)。しかし、その後反応時間が1時間から2時間の間で結 晶数は大幅に減少していることが明らかとなった。また、その減少に伴い結晶サイズ は大幅に大きくなり、その後は徐々に増大し続けていることが示された(図 6.4b,c)。 これらの結果から、まず1時間以内の反応過程では結晶核の生成が優先的に起こって いることが明らかとなった。その後に結晶成長が起こるが、その際、サイズの小さい 結晶は比表面積が大きく不安定な状態であり、隣接している結晶同士が融合しやすい ため、初期段階に結晶サイズが大幅に大きくなったと考えられる。



Figure 6.2. (a) SEM image and (b) experimental and simulated XRD patterns of ZIF-8 crystals and polyimide film.



Figure 6.3. SEM images of the crystals prepared at different reaction time. Scale bars are 500 nm.



Figure 6.4. Variation in (a) crystal number, (b) crystal size obtained at initial reaction stage, and (c) crystal size as a function of reaction time.

6.3.2 NaNO3 濃度が ZIF-8 の結晶成長速度に及ぼす影響

NaNO₃ 濃度が ZIF-8 の結晶成長速度に及ぼす影響について評価するため、MeIM 濃度は 500 mM で固定し、NaNO₃ 濃度を 50, 100, 200 mM と変化させて ZIF-8 の反応経時変化を SEM にて観察した(図 6.5)。各 NaNO₃ 濃度条件下で1時間後に得られた試料を比較すると、結晶サイズに大きな差はみられなかったが、フィルム上に析出した



Figure 6.5. SEM images of the crystals prepared at different reaction time for $NaNO_3$ concentration of 50-200 mM. The MeIM ligand concentration was fixed at 500 mM. Scale bars are 500 nm.



Figure 6.6. Variation in (a) crystal number, (b) crystal size obtained at initial reaction stage, and (c) crystal size as a function of reaction time.

結晶数は NaNO₃ 濃度の増大に伴い増えていることが分かる。実際、反応初期段階に 析出した結晶数ならびに結晶サイズを算出したところ、反応時間が1時間までは、結 晶の析出数はNaNO₃濃度の増大に伴い多くなっていることが確認できた(図6.6a,b)。 これは、ポリイミドフィルム内にドープした亜鉛イオンの溶出はNaNO₃のNa⁺とのイ オン交換反応に基づいているため、NaNO₃濃度が高い条件下ではドープした金属イオ ンの溶出速度が速くなる。そのような条件では核形成がより優先的に起こるため、結 晶が多く析出したと考えられる。また、上項の結果同様、1時間後までは各濃度条件 下で結晶の析出数は増大し続けているが、その後反応時間が1時間から2時間の間で 結晶数は減少していることが確認できた。さらに、その減少に伴い結晶サイズは大幅 に大きくなり、その後は徐々に増大し続けていることも明らかとなった(図 6.6b,c)。 すなわち、NaNO3濃度を変化させても1時間以内の反応過程では結晶核の生成が優先 的に起こっており、その後、結晶同士の融合を介しながら成長していると考えられる。 また、反応時間が1時間から1時間半の間での結晶数の減少度合いは、NaNO3濃度が 高い条件下でより大きくなっているが、これは結晶の析出数が多いため隣接している 結晶が多く、結晶同士の融合が起こりやすくなっているためであると考えられる。そ のため、成長初期段階における結晶サイズは、NaNO3 濃度が高い条件下でより顕著に 大きくなっていることが分かる。200 mM NaNO3条件下では1時間半以降に結晶数の 減少が確認されなかったことから、この段階で十分に安定性の高い結晶が得られ、結 晶同士が融合することなく前駆体の供給のみに基づいて成長していると考えられる。 一方、100 mM NaNO3条件下では1時間半以降も結晶数が減少しているため、結晶同 士の融合を介しながら成長していることが分かる。そのため、2時間後の段階では、 100 mM NaNO3条件下でサイズの大きい ZIF-8 結晶が形成されたと考えられる。

また、10時間後ならびに72時間後に得られた試料のSEM 観察結果(図 6.5)を比較すると、NaNO3 濃度の増大に伴いZIF-8 膜の結晶サイズは小さくなっていることが分かる。すなわち、核形成段階に析出した結晶数が多い条件ほど、最終的に得られるZIF-8 膜の結晶サイズは小さくなることが確認できた。以上の結果より、NaNO3 濃度が高い条件下では、ドープした金属イオンの溶出速度が大きくなるため核形成が優先的に起こり、結晶サイズの小さいZIF-8 膜が形成される。一方、NaNO3 濃度が低い条件下では、ドープした金属イオンの溶出速度は小さくなるため核形成が抑制され、結晶成長が優先的に起こるため結晶サイズの大きいZIF-8 膜が形成されることが明らかとなった。

6.3.3 リガンド濃度が ZIF-8 の結晶成長速度に及ぼす影響

次いで、MeIM 濃度が ZIF-8 の結晶成長速度に及ぼす影響について評価するため、 NaNO₃濃度は 100 mM で固定し、MeIM 濃度を 250, 500 mM, 1 M と変化させて ZIF-8



Figure 6.7. SEM images of the crystals prepared at different reaction time for MeIM ligand concentration of 250 mM-1.0 M. The NaNO₃ concentration was fixed at 100 mM. Scale bars are 500 nm.



Figure 6.8. Variation in (a) crystal number, (b) crystal size obtained at initial reaction stage, and (c) crystal size as a function of reaction time.

の反応経時変化を SEM にて観察した(図 6.7)。各 MeIM 濃度条件下で1時間後に得られた試料を比較すると、結晶サイズに大きな差はみられなかったが、結晶の析出量は MeIM 濃度の増大に伴い増えていることが分かる。実際、反応初期段階に析出した結晶数ならびに結晶サイズを算出したところ、反応時間が1時間までは、結晶の析出数は MeIM 濃度の増大に伴い多くなっていることが確認できた(図 6.8a,b)。本系で

は、NaNO3濃度を固定しているためドープした金属イオンの溶出速度は一定であるが、 MeIM 濃度に依存して結晶数に違いが出たのは、MeIM 濃度が高い条件ではポリイミ ドフィルム界面に溶出してきた金属イオンが直ぐに MeIM と反応するため、核形成が より優先的に起こり結晶が多く析出したと考えられる。すなわち、MeIM 濃度が低い 条件下では溶出してきた亜鉛イオンとの衝突頻度が低くなるため、溶液中にロスされ た亜鉛イオン量が増えていると考えられる。また本系においても、1時間後までは250 mM MeIM 条件を除く各濃度条件下で結晶の析出数は増大し続けているが、その後反 応時間が1時間から2時間の間で結晶数は減少していることが確認できた。そして、 その減少に伴い結晶サイズは大幅に大きくなり、その後は徐々に増大し続けているこ とが示された(図 6.8b,c)。したがって、MeIM 濃度を変化させても1時間以内の反応 過程では結晶核の生成が優先的に起こっており、その後、結晶同士の融合を介しなが ら成長していることが明らかとなった。また NaNO₃ 濃度を変化させた系と同様、反 応時間が1時間から1時間半の間での結晶数の減少度合いは、核形成段階における結 晶の析出数が多い条件下でより大きくなっており、それに応じて結晶サイズは大幅に 大きくなっていることが確認できた。一方、250 mM MeIM 条件下では1時間以降も 結晶数の減少がみられなかった。これは、核形成段階における結晶の析出量が少なく 隣接している結晶が存在しないため、結晶同士が融合することなく MOF 前駆体の供 給のみに基づいて成長しているためであると考えられる。

また、10時間後ならびに72時間後に得られた試料のSEM観察結果(図6.7)を比較すると、MeIM濃度の増大に伴いZIF-8膜の結晶サイズは小さくなっていることが分かる。すなわち、核形成段階に析出した結晶数が多い条件ほど、最終的に得られるZIF-8膜の結晶サイズは小さくなることが確認できた。本系は、NaNO3濃度を固定しているためドープした金属イオンの溶出速度は一定であるが、MeIM濃度の高い条件下では溶出した亜鉛イオンがMeIMと直ぐに反応するため、核形成が優先的に起こり結晶サイズの小さいZIF-8膜が形成される。一方、MeIM濃度が低い条件下では溶出した亜鉛イオンとの衝突頻度が低くなるため核形成が抑制され、結晶成長が優先的に起こることにより結晶サイズの大きいZIF-8膜が形成されることが明らかとなった。

6.3.4 金属イオンの溶出速度と ZIF-8 の結晶成長速度の系統的制御

上記結果より、NaNO3ならびに MeIM 濃度を調整することにより、ZIF-8の核形成



Figure 6.9. SEM images of the crystals prepared by changing both concentration of NaNO₃ and MeIM ligands. The reaction time is 1 h. The scale bars are 500 nm.



Figure 6.10. SEM images of the crystals prepared by changing both concentration of NaNO₃ and MeIM ligands. The reaction time is 72 h. The scale bars are 500 nm.



Figure 6.11. Variation in (a) crystal size of samples prepared after 1 h, and (b) crystal number and (c) crystal size of samples prepared after 72 h at different concentration of NaNO₃ and MeIM.

および結晶成長速度を制御することが可能であり、結晶サイズの異なる ZIF-8 膜が形 成されることが明らかとなった。さらに本項では、NaNO3および MeIM 濃度を系統的 に調整することで、それぞれの濃度が ZIF-8 の結晶形成速度に及ぼす影響について詳 細に評価した。NaNO₃濃度および MeIM 濃度をともに変化させ、1 時間ならびに 72 時 間後に得られた試料の SEM 観察結果を図 6.9 および 6.10 に示す。まず図 6.9 より、 各濃度条件下で1時間後に得られた ZIF-8 膜の結晶サイズに大きな差はみられなかっ たが、結晶の析出量は NaNO3 および MeIM 濃度がともに高い条件下でより多くなっ ていることが明らかとなった。特に、200 mM NaNO3, 1.0 M MeIM 条件下では、1 時間 後の段階で既に結晶が密に析出しており、連続膜が形成されていることが分かる。一 方、72時間後に得られた試料の SEM 観察結果(図 6.10)を比較すると、ZIF-8 膜の 結晶サイズは 1 時間後に析出している結晶数が少ない条件下でより大きくなってい ることが確認できた。実際、それぞれの濃度条件下で1時間後に析出した結晶数なら びに結晶サイズを算出したところ、結晶サイズに大きな違いはみられなかったが、結 晶の析出数は NaNO3 ならびに MeIM 濃度の増大に伴い多くなっていることが確認で きた(図 6.11a,b)。また、NaNO3 濃度を変化させたときより、MeIM 濃度を変化させ たときの方が結晶数はより顕著に変化していることが明らかとなった。これは、本合 成プロセスではドープした金属イオンの溶出速度だけでなく、亜鉛イオンと MeIMの 反応速度も ZIF-8 の核形成段階に大きな影響を及ぼしていることを意味する。また図 6.11c より、72 時間後に得られた ZIF-8 膜の結晶サイズは、1 時間後に析出している 結晶数が多い順に小さくなっていることが確認できた。

6.3.5 ZIF-8 の結晶成長メカニズム

上記の結果をもとに、ZIF-8の結晶成長メカニズムを図 6.12 に示す。NaNO3 および MeIM 濃度がともに低い条件下では、ドープした金属イオンの溶出速度は遅くかつリ ガンドとの衝突頻度も低いため、反応初期の核形成段階が抑制される。その結果、前 駆体は結晶成長に優先的に消費され、結晶サイズの大きい ZIF-8 膜が形成される。一 方、NaNO3 と MeIM 濃度がともに高い条件下では、ドープした金属イオンの溶出速度 およびリガンドとの反応速度がともに速くなるため、核形成が優先的に起こり結晶サ イズの小さい ZIF-8 膜が生成される。また本合成系では、亜鉛イオンと MeIM との反 応が ZIF-8 形成の律速段階であるため、MeIM 濃度が高い条件下では NaNO3 濃度が低 くても核生成が優先的に起こり、比較的サイズの小さい ZIF-8 が形成される。一方、 MeIM 濃度が低い条件下では NaNO3 濃度が高くても結晶成長が優先的に起こり、比較 的サイズの大きい ZIF-8 が形成されることが明らかとなった。このように、本合成プ ロセスでは NaNO3 とリガンド濃度を調整することで、MOFの核形成および結晶成長 速度を合理的に制御することが可能である。その結果、サイズ均一性が高く、加えて



Figure 6.12. Schematic representation of proposed approach for formation of ZIF-8 crystals based on the independent control of elution rate and growth rate.

幅広いレンジで結晶サイズを系統的に制御した MOF 連続膜を作製することが可能で あることを示した。

6.4 まとめ

金属イオンドープ高分子フィルム上での MOF の結晶成長プロセスの合目的制御に ついて検討し、以下の結論を得た。

ポリイミドフィルム内にドープした金属イオンを溶出させるためのモジュレーターとして硝酸ナトリウムを利用することで、イオン交換基をもたない有機配位子から構築される MOF 膜の作製に成功した。

2) 硝酸ナトリウム濃度とリガンド濃度を調整することで MOF の核形成および結晶成 長速度を合理的に制御することができ、サイズ均一性が高くかつ制御可能な MOF 連 続膜作製することが可能である。

本研究では、金属イオンの溶出と MOF の結晶成長を独立して制御することのでき るシステムを確立することで、イオン交換基をもたない有機配位子から構築される MOF には適用できないといった本手法の課題を克服することに成功した。第4章か らの研究成果も踏まえ、本提案手法は汎用性が高いことに加え、one-pot 反応で MOF 膜形成において重要な構造パラメーターである膜厚・結晶配向・連続性・均一性・サ イズを合目的に制御することが可能であることが明らかとなり、現行の MOF 膜作製 手法が抱える問題点をクリアした新たな MOF 膜作製技術として今後の展開が期待さ れる。

80

第7章 本研究のまとめ

本研究では第1章で述べたように、MOF を機能性ユニットとした高機能ナノ構造 体作製のために重要な「固体材料界面での MOF の自己組織化プロセスの制御」を取 り上げ、現行法の問題点をまとめ、それらを克服するための新規技術の創製に取り組 んだ。MOF の機能のオンデマンド設計が要望される中で、無機微粒子や二次元基板 などの材料表面上で MOF の結晶成長を制御することのできる合成手法は、MOF の利 点を飛躍的に高めた機能性材料の創製を可能にすることから、現在、ナノ材料科学の 分野に携わる研究者の関心を集めている。本研究においても、MOF の高機能化を目 的とした固体材料/反応溶液での固液界面反応を基調とする簡便かつ制御性に優れた MOF 作製技術の開発を通じて様々な興味深い知見が得られた。以下に、それらをま とめる。

1)金属イオンドープ固体材料表面上での選択的 MOF 形成プロセス

金属ナノ粒子表面を高分子である PVP 分子にて修飾することにより、MOF 前駆体 である金属イオンをあらかじめナノ粒子表面上に大量かつ化学的に局在化させるこ とが可能であり、続いて有機配位子と反応させることで MOF の核形成・結晶成長が ナノ粒子表面上に限定されることが明らかとなった。一方、PVP 修飾金属ナノ粒子を 用いても、金属イオンの局在化処理を施さずに複合体合成を行うと凝集体が形成され たことから、MOF の自己組織化サイトを特定位置に限定するためには「金属イオン をその位置に局在化させることが鍵である」という重要な知見を得ることができた。 上記の知見は、二次元基板界面での MOF 合成にも適用可能であることを明らかと した。金属イオンをドープしたポリイミドフィルムを MOF 形成の支持基板ならびに 金属イオン源として利用することで MOF 膜の作製に成功した。本手法において、ド ープした金属イオンの溶出は有機配位子のプロトンとのイオン交換反応に基づいて いるため、金属イオンはポリイミドフィルムから一様に溶出され、直ぐに溶液中の有 機配位子と反応することでフィルム界面にて均一に MOF の結晶核が生成される。し

たがって本手法では、one-pot 反応でも均一性の優れた MOF 連続膜を作製することが 可能である。また、ポリイミドフィルムは表面改質時間を調整することにより金属イ オンの吸着量を合理的に制御することができ、その吸着金属イオン量を調整したポリ イミドフィルムを用いることで MOF 膜の厚みを制御することも可能である。加えて、 ポリイミドフィルム内にドープする金属イオン種および有機配位子の種類を変える ことで、様々なフレームワークに適用可能であることが明らかとなった。

これらの成果は、未だ多くの問題点を抱えている固体材料界面での MOF 合成研究 に一石を投じる革新的結果であり、触媒、センシング、分離、吸着などを必要とする 様々に分野において有用な材料を提供することが可能になると予想される。

MOF 膜の配向制御可能な新たな概念の実証

金属イオンドープポリイミドフィルムを用いることによりピラードレイヤー型 MOF の結晶配向を制御することが可能であった。イオン交換反応に基づいた本手法 では、one-pot 反応でも二次元レイヤーの形成とピラー配位子の架橋を 2 段階に分け て制御することが可能であり、反応初期に形成される二次元レイヤーの向きが得られ る MOF 膜の結晶配向を決定付けると考えられる。本実験では、溶媒の極性ならびに レイヤーリガンドの濃度を調整することで MOF 膜の配向を制御することができたこ とから、二次元レイヤーとポリイミドフィルム間の化学的相互作用の強さと、二次元 レイヤーのサイズおよび析出量がフィルム上でレイヤーの向きを制御するための重 要なパラメーターであることが明らかとなった。すなわち、基板と MOF 構成要素間 の化学的相互作用およびドープした金属イオンの溶出速度という極めてシンプルな 合成パラメーターを制御するだけで、従来は困難であった one-pot 合成での結晶配向 制御を可能とした。この成果は、結晶配向の揃った MOF 膜を作製する際の新たな設 計指針となりえ、学術的に非常に意義深いものである。

3) 高分子フィルム上での MOF 結晶形成プロセスの合目的制御

ポリイミドフィルム内にドープした金属イオンを溶出させるためのモジュレータ ーとして硝酸ナトリウムを利用することで、イオン交換基をもたない有機配位子から 構築される MOF 膜の作製にも成功した。本合成プロセスでは、硝酸ナトリウムは金 属イオンの溶出のみに関与し、有機配位子は MOF の結晶成長のみに関与するシステ ムとなっており、それぞれを独立して制御することが可能である。したがって、硝酸 ナトリウム濃度とリガンド濃度を調整することで MOF の核形成および結晶成長速度 を合理的に制御することができ、サイズ均一性が高くかつ制御可能な MOF 連続膜を 作製することが可能であることが明らかとなった。上記の研究成果も踏まえ、本手法 は汎用性が高いことに加え、one-pot 反応で MOF 膜形成において重要な構造パラメー ターである膜厚・配向・連続性・均一性・サイズを合目的に制御することも可能であ ることから、新たな MOF 膜作製技術として非常に有用であると考えられる。

本研究では、MOF の合成プロセスを物理化学的視点からアプローチすることによ り、固液界面における MOF 形成に対して速度論的支配による自己組織化プロセスの 制御という新しいコンセプトを提案するだけでなく、MOF をベースとした機能性ナ ノ構造体合成の設計指針となりえる「固体材料界面での自己組織化プロセスのデータ ベース化」を目指す試みとして、学術的に非常に重要な基礎研究である。本研究にて 得られた成果は、物資の分離や吸着、センシング、触媒反応などを必要とする様々な 分野において有用な材料を提供することが可能になると予想され、本研究の推進は意 義深いものであると考えられる。

謝辞

本研究の遂行にあたり、終始熱心なご指導、ご鞭撻をいただきました甲南大学 フ ロンティアサイエンス学部 准教授 鶴岡孝章 先生に厚くお礼申し上げます。

本論文を御校閲いただき、ご指導、ご助言を賜りました甲南大学フロンティアサイ エンス学部 教授 村嶋貴之 先生、教授 赤松謙祐 先生に深く感謝致します。

本論文を御校閲いただき、多くのご意見を下さいました大阪府立大学 大学院工学 研究科 教授 髙橋雅英 先生に深く感謝致します。

本研究の遂行にあたり、終始親身にご指導およびご助言をいただきました甲南大学 フロンティアサイエンス学部 講師 高嶋洋平 先生にお礼申し上げます。

金属ナノ粒子@mSiO₂@MOF 3 層構造体の物性評価ならびに高分子フィルム表面上 での MOF の結晶配向制御に関する研究を遂行するに当たり、貴重なご助言をいただ きました京都大学 高等研究院 准教授 堀毛悟史 先生、関西学院大学 理工学部 准 教授 田中大輔 先生にお礼申し上げます。

また、日々の研究生活を共に送ったフロンティアサイエンス学部 生命化学科 ナノ 材料科学研究室の諸先輩方、大学院生ならびに4回生の皆様方に感謝致します。なか でも、MOF 合成に関する研究を共に行ってくれた藤本聖也 氏、井上康平 氏に深く 感謝致します。

大学および大学院における9年間、苦楽を共にした良き友人たちならびにお世話に なった皆様方に感謝します。

最後に、長い間学生として勉強する機会を与えていただき、協力して下さった両親 と家族に感謝します。

平成 31 年 2 月

大橋 卓史

論文リスト

公表論文(副論文)リスト

T. Ohhashi, T. Tsuruoka, H. Nawafune, and K. Akamatsu

"Controlled Synthesis of Metal-Organic Framework Films on Metal Nanoparticles by the Versatile Layer-by-Layer Assembly Approach"

Trans. Mater. Res. Soc. Japan 39,153-156 (2014)

T. Ohhashi, T. Tsuruoka, T. Matsuyama, Y. Takashima, H. Nawafune, H. Minami, and K. Akamatsu

"Metal nanocrystal/metal-organic framework core/shell nanostructure from selective selfassembly induced by localization of metal ion precursors on nanocrystal surface"

J. Colloid Interface Sci. 451, 212-215 (2015)

T. Tsuruoka, M. Kumano, K. Mantani, T. Matsuyama, A. Miyanaga, <u>T. Ohhashi</u>, Y. Takashima, and K. Akamatsu "Interfacial Synthetic Approach for Constructing Metal-Organic Framework Crystals Using Metal Ion-Doped Polymer Substrate" *Cryst. Growth Des.* 16, 2472-2476 (2016)

T. Tsuruoka, K. Mantani, A. Miyanaga, T. Matsuyama, <u>T. Ohhashi</u>, Y. Takashima, and K. Akamatsu

"Morphology Control of Metal-Organic Frameworks Based on Paddle-Wheel Units on Ion-Doped Polymer Substrate Using an Interfacial Growth Approach"

Langmuir 32, 6068-6073 (2016)

T. Tsuruoka, T. Matsuyama, A. Miyanaga, T. Ohhashi, Y. Takashima, and K. Akamatsu

"Site-selective growth of metal-organic frameworks using an interfacial growth approach combined with VUV photolithography"

RSC Adv. 6, 77297-77300 (2016)

<u>T. Ohhashi</u>, T. Tsuruoka, K. Inoue, Y. Takashima, S. Horike, and K. Akamatsu "An integrated function system using metal nanoparticle@mesoporous silica@metal-organic framework hybrids"

Microporous and Mesoporous Materials 245, 104-108 (2017)

T. Tsuruoka, A. Miyanaga, <u>T. Ohhashi</u>, M. Hata, Y. Takashima, and K. Akamatsu "Rational Composition Control of Mixed-Lanthanide Metal-Organic Frameworks by an Interfacial Reaction with Metal Ion-Doped Polymer Substrates"

J. Solid State Chem. 253, 43-46 (2017)

<u>T. Ohhashi</u>, T. Tsuruoka, S. Fujimoto, Y. Takashima, S. Horike, and K. Akamatsu "Controlling the Orientation of Metal-Organic Framework Crystals by an Interfacial Growth Approach Using a Metal Ion-Doped Polymer Substrate" *Cryst. Growth Des.* 18, 402-408 (2018)

T. Tsuruoka, K. Inoue, A. Miyanaga, K. Tobiishi, <u>T. Ohhashi</u>, M. Hata, Y. Takashima, and K. Akamatsu

"Crystal conversion between metal-organic frameworks with different crystal topologies for efficient crystal design on two-dimensional substrates"

J. Cryst. Growth 487, 1-7 (2018)

総説リスト

鶴岡孝章, <u>大橋卓史</u>, 髙嶋洋平, 赤松謙祐

「金属ナノ粒子/多孔性有機金属錯体コアシェルナノ構造体の作製」 化学工業誌, 66, 41-45 (2015)

学会発表リスト

<u>大橋卓史</u>、長内良憲、鶴岡孝章、縄舟秀美、赤松謙祐 「無機ナノ粒子/多孔性有機金属錯体複合ナノ結晶の作製」 第 64 回コロイドおよび界面化学討論会、名古屋大学(2013 年)

大橋卓史、長内良憲、鶴岡孝章、縄舟秀美、赤松謙祐

「無機ナノ粒子/多孔性有機金属錯体複合化による新規ハイブリッド材料の作製及び 構造制御」

錯体化学会第63回討論会、琉球大学(2013年)

大橋卓史、鶴岡孝章、縄舟秀美、赤松謙祐

「無機ナノ粒子表面上での多孔性有機金属錯体の自己集合化による複合ナノ結晶の 作製および構造制御」

第15回関西表面技術フォーラム、岡山大学(2013年)

T. Ohhashi, T. Tsuruoka, H. Nawafune, K. Akamatsu

"Controlled Synthesis of Metal-Organic Framework films on Metal Nanoparticles by a Versatile Layer-by-Layer Assembly Approach"

23rd Annual Meeting of MRS-Japan 2013, Yokohama, Japan (2013)

大橋卓史、鶴岡孝章、縄舟秀美、赤松謙祐

「マイクロウェーブ照射法による金属ナノ粒子/多孔性有機金属錯体コア-シェルナノ 構造体の作製」

日本化学会 第94春季年会、名古屋大学(2014年)

大橋卓史、鶴岡孝章、赤松謙祐

「金属ナノ粒子/多孔性有機金属錯体コア-シェルナノ構造体の作製」

ナノ学会第12回大会、京都大学(2014年)

T. Ohhashi, T. Tsuruoka, and K. Akamatsu

"Controlled Synthesis of Ag Nanoparticle/Metal-Organic Framework Core-Shell Nanostructures"

4th International Conference on Metal-Organic Frameworks & Open Framework Compounds (mof 2014), Kobe, Japan (2014)

大橋卓史、鶴岡孝章、髙嶋洋平、赤松謙祐

「ナノ粒子表面上での選択的 MOF 成長による金属ナノ粒子/MOF コア-シェル構造体の作製」

錯体化学第64回討論会、中央大学(2014年)

大橋卓史、鶴岡孝章、髙嶋洋平、赤松謙祐

「コア/シェル構造体の作製を目的とした金属ナノ結晶表面上での金属有機構造体の 選択的成長」

日本化学会 第95春季年会、日本大学(2015年)

大橋卓史、鶴岡孝章、髙嶋洋平、赤松謙祐

「構造制御可能でかつ汎用性に優れた無機ナノ結晶/MOF 複合ナノ結晶創製技術の開発」

錯体化学第65回討論会、奈良女子大学(2015年)

大橋卓史、鶴岡孝章、髙嶋洋平、赤松謙祐

「機能性無機ナノ結晶表面上での多孔性有機金属錯体の形態制御」

第17回関西表面技術フォーラム、甲南大学(2015年)

大橋卓史、鶴岡孝章、髙嶋洋平、赤松謙祐

「階層的に機能化された機能性無機ナノ結晶/多孔性有機金属錯体複合材料の創製」

日本化学会 第96春季年会、同志社大学(2016年)

T. Ohhashi, T. Tsuruoka, T. Takashima, and K. Akamatsu

"Synthesis of Hierarchically Metal Nanoparticle/Mesoporous Silica/Metal-Organic Frameworks Nanostructures"

EMN Meeting on Nanoparticles, Singapore (2016)

<u>大橋卓史</u>、鶴岡孝章、藤本聖也、髙嶋洋平、赤松謙祐 「固液界面での配位高分子形成メカニズムの解明」 日本化学会 第97春季年会、慶応義塾大学(2017年)

大橋卓史

「2次元フレームワークユニットと高分子基板間の化学的相互作用を利用した多孔性 金属錯体の結晶配向制御」

錯体化学若手の会夏の学校 2017、愛知(2017 年)

大橋卓史、鶴岡孝章、髙嶋洋平、赤松謙祐

「金属ナノ粒子@メソポーラスシリカ@多孔性金属錯体3層構造体の作製」 第68回コロイドおよび界面化学討論会、神戸大学(2017年)

大橋卓史、鶴岡孝章、藤本聖也、髙嶋洋平、赤松謙祐

「金属イオンドープ高分子基板上での多孔性金属錯体の結晶配向制御」 錯体化学第67回討論会、北海道大学(2017年)

T. Ohhashi, T. Tsuruoka, T. Takashima, and K. Akamatsu

"Interfacial Synthetic Approach for Constructing Metal-Organic Framework Crystals Using Metal Ion-Doped Polymer Substrate"

The 4th International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2017, Busan, Korea (2017)

<u>T. Ohhashi</u>, T. Tsuruoka, S. Fujimoto, Y. Takashima, and K. Akamatsu
"Controlling the Orientation of Metal-Organic Framework Crystals by an Interfacial Growth Approach Using a Metal Ion-Doped Polymer Substrate"
日本化学会 第 98 春季年会、日本大学(2018 年)

<u>T. Ohhashi</u>, T. Tsuruoka, S. Fujimoto, Y. Takashima, and K. Akamatsu "Controlling the Orientation of Metal-Organic Framework Crystals by an Interfacial Growth Approach Using a Metal Ion-Doped Polymer Substrate" 43rd International Conference on Coordination Chemistry, ICCC 2018, Sendai, Japan (2018)

<u>T. Ohhashi</u>, S. Fujimoto, Y. Takashima, K. Akamatsu, and T. Tsuruoka, "Controlling the Orientation of Metal-Organic Framework Crystals by an Interfacial Growth Approach Using a Metal Ion-Doped Polymer Substrate" EMN Barcelona Meeting 2018, Barcelona, Spain (2018)

大橋卓史、鶴岡孝章、髙嶋洋平、赤松謙祐

「金属ナノ粒子@メソポーラスシリカ@多孔性金属錯体3層構造体の作製」 第20回関西表面技術フォーラム、甲南大学(2018年)